



Jorge Manuel García Martínez

Generado desde: Editor CVN de FECYT

Fecha del documento: 28/01/2021

v 1.4.3

4740405ba590cd9dd9468beef254f2b8

Este fichero electrónico (PDF) contiene incrustada la tecnología CVN (CVN-XML). La tecnología CVN de este fichero permite exportar e importar los datos curriculares desde y hacia cualquier base de datos compatible. Listado de Bases de Datos adaptadas disponible en <http://cvn.fecyt.es/>

Resumen libre del currículum

Descripción breve de la trayectoria científica, los principales logros científico-técnicos obtenidos, los intereses y objetivos científico-técnicos a medio/largo plazo de la línea de investigación. Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Durante mi tesis doctoral estudié los efectos de confinamiento cuántico en la superficie de metales nobles. Mi interés por el confinamiento cuántico me llevó a trabajar en puntos cuánticos autoensamblados (QD) fabricados por epitaxia de haces moleculares (MBE), labor que comenzó durante mi estancia post-doctoral en la Universidad de California, Santa Barbara, USA.

Inventé un método para la fabricación de anillos cuánticos (QR) auto-ensamblados basado en el control preciso de las condiciones del recubrimiento de QD. Así mismo he sido pionero e inventor de un método para la sintonización de niveles energéticos de QD. Mi trabajo contribuyó a establecer un método para implementar la ingeniería de banda prohibida de puntos cuánticos (QD Band Gap Engineering). Técnica utilizada hoy en día en multitud de laboratorios para la ecualización del tamaño de puntos cuánticos.

En el IMM (actualmente IMN) he realizado medidas pioneras de tensión acumulada en materiales III-V durante la formación de nanoestructuras de InAs (puntos, anillos e hilos cuánticos). Estos resultados revelaron la presencia de In "líquido" durante el crecimiento de InAs/GaAs(001). También he contribuido a explicar los mecanismos de formación de los hilos cuánticos de InAs en InP(001). Los hilos presentan una emisión óptica a temperatura ambiente a 1.55 micras. La posibilidad de utilizarlos como emisores láser para su uso en telecomunicaciones se desarrolló en el proyecto Europeo NANOMAT, del cual fui IP.

En 2007 me planteé el reto de fabricar grafeno por MBE. Para ello inicié una estancia sabática de dos años de duración con una ayuda Salvador de Madariaga en Bell Labs, USA con el Prof. L.N. Pfeiffer. Fue necesario el diseño y construcción de un equipo de MBE. En colaboración con el Prof. A. Pinczuk (Columbia University, NY), hemos logrado el crecimiento de capas de grafeno de alta calidad en área extendida por MBE sobre nitruro de boro hexagonal. El elevado impacto tecnológico de esta línea de trabajo lo demuestran las patentes realizadas.

Ya de vuelta al IMN, he trabajado en el uso de la tecnología de crecimiento por MBE para la integración híbrida de semiconductores compuestos basados en GaAs y de grafeno. Se ha demostrado que el galio presenta una actividad catalítica similar a otros metales para la formación de grafeno en el proyecto nacional "Integración del crecimiento de grafeno en la tecnología de semiconductores compuestos", MAT2015-67021-R.

He desarrollado y transferido tecnología al International Iberian Nanotechnology Lab (INL) para la fabricación de células solares de película delgada CIGS, a través del proyecto "Colaboración IMM-CSIC con el International INL en desarrollo de instrumentación para procesos de recubrimientos especiales en sensores" (AIC-B-2011-0806) del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica.

En conjunción con el esfuerzo de dirección del IMN-CNM en los últimos 7.5 años, mi objetivo científico actual es el desarrollo de sistemas de alta eficiencia de recolección de energía solar fotovoltaica para ángulos rasantes de incidencia de los rayos del sol. A raíz



de éstos desarrollos el Dr. José M. Ripalda y yo hemos fundado en 2020 una empresa de base tecnológica (EBT) llamada FutureVoltaics S.L. También estoy desarrollando en colaboración con la Dra. Sahba Mobini un dispositivo para el crecimiento de material biológico por electroestimulación, basada en nuestra patente del 2020.



Indicadores generales de calidad de la producción científica

Descripción breve de los principales indicadores de calidad de la producción científica (sexenios de investigación, tesis doctorales dirigidas, citas totales, publicaciones en primer cuartil (Q1), índice h....). Incluye también otros aspectos o peculiaridades importantes.

Índice H es 43.

Citas totales es >7133.

Promedio de citas/año es de 246.

Número total de publicaciones en primer cuartil (Q1) es de 102.

Tres Tesis doctorales dirigidas

"Nanoestructuras auto-ensambladas mediante epitaxia por haces moleculares de InAs sobre substratos de GaAs(001): de los puntos a los anillos cuánticos" (2006),

Autor: Daniel Granados Ruiz

Director: **Jorge M. García**

Centro: Universidad Autónoma de Madrid

"Control de la forma, tamaño y composición de nanoestructuras de semiconductores III-V: anillos y puntos cuánticos" (2010)

Autor: Alfonso González Taboada

Directores: José María Ripalda Cobián y **Jorge M. García**

Centro: Universidad Autónoma de Madrid

"Graphene synthesis on a surface by molecular beam epitaxy using a carbon-solid source"(2018)

Autor: Irene Hernández-Rodríguez

Directores: Javier L. Méndez y **Jorge M. García**

Centro: Universidad Autónoma de Madrid

Sexenios, quinquenios y trienios

1 sexenio de transferencia (2010-2018)

4 sexenios de investigación (91-96, 97-02, 03-08, 09-14).

5 quinquenios de investigación (91-95, 96-00, 01-05, 06-10, 11-15)

7 trienios



Jorge Manuel García Martínez

Apellidos: **García Martínez**
Nombre: **Jorge Manuel**
ORCID: **0000-0001-6906-6268**
ScopusID: **7406131310**
ResearcherID: **B-5221-2008**
Fecha de nacimiento: **19/02/1967**
Sexo: **Hombre**
Nacionalidad: **España**
País de nacimiento: **España**
C. Autón./Reg. de nacimiento: **Comunidad de Madrid**
Provincia de contacto: **Madrid**
Ciudad de nacimiento: **Madrid**
Dirección de contacto: **Calle Isaac Newton, 8**
Código postal: **28760**
País de contacto: **España**
C. Autón./Reg. de contacto: **Comunidad de Madrid**
Ciudad de contacto: **Tres Cantos**
Teléfono fijo: **(+34) 918060786**
Correo electrónico: **jm.garcia@csic.es**
Teléfono móvil: **(+34) 636666436**
Página web personal: **<https://cvn.fecyt.es/0000-0001-6906-6268>**

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Departamento: Instituto de Micro y Nanotecnología-CNM
Categoría profesional: Director del Instituto de Micro y Nanotecnología-CNM
Fecha de inicio: 21/06/2017
Modalidad de contrato: Funcionario/a **Régimen de dedicación:** Tiempo completo
Funciones desempeñadas: Director del centro

Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Departamento: Instituto de Microelectrónica de Madrid
Categoría profesional: Director del Instituto de Microelectrónica de Madrid
Fecha de inicio: 18/04/2013
Modalidad de contrato: Funcionario/a **Régimen de dedicación:** Tiempo completo

Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Departamento: Fabricación y caracterización de nanoestructuras, Instituto de Microelectrónica de Madrid
Categoría profesional: Investigador científico
Fecha de inicio: 25/05/2007
Modalidad de contrato: Funcionario/a **Régimen de dedicación:** Tiempo completo



Primaria (Cód. Unesco): 221125 - Semiconductores

Secundaria (Cód. Unesco): 221103 - Crecimientos de cristales

Terciaria (Cód. Unesco): 221102 - Materiales compuestos

Identificar palabras clave: Caracterización; Hilos cuánticos; Puntos cuánticos

Cargos y actividades desempeñados con anterioridad

	Entidad empleadora	Categoría profesional	Fecha de inicio
1	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	Científico Titular	11/08/2000
2	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	Científico Titular Interino	23/12/1999
3	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	Investigador Contratado	01/01/1998
4	Consejo Superior de Investigaciones Científicas	Investigador Científico	25/05/2007

- | | |
|--|---|
| <p>1 Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Categoría profesional: Científico Titular
Fecha de inicio-fin: 11/08/2000 - 24/05/2007</p> | <p>Tipo de entidad: Agencia Estatal
Duración: 6 años - 10 meses - 12 días</p> |
| <p>2 Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Categoría profesional: Científico Titular Interino
Fecha de inicio-fin: 23/12/1999 - 10/08/2000</p> | <p>Tipo de entidad: Agencia Estatal
Duración: 8 meses - 18 días</p> |
| <p>3 Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Categoría profesional: Investigador Contratado
Fecha de inicio-fin: 01/01/1998 - 22/12/1999</p> | <p>Tipo de entidad: Agencia Estatal
Duración: 1 año - 11 meses - 20 días</p> |
| <p>4 Entidad empleadora: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Categoría profesional: Investigador Científico
Fecha de inicio: 25/05/2007</p> | <p>Tipo de entidad: Agencia Estatal</p> |



Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores, Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

1 Titulación universitaria: Master

Nombre del título: X Programa de Liderazgo para la Gestión Pública

Entidad de titulación: IESE Business School

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

Fecha de titulación: 01/07/2014

2 Titulación universitaria: Titulado Superior

Nombre del título: Licenciado en Ciencias

Entidad de titulación: Universidad Autónoma de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 1990

Doctorados

Programa de doctorado: Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Físicas

Entidad de titulación: Universidad Autónoma de
Madrid

Tipo de entidad: Universidad

Fecha de titulación: 1995

Formación especializada, continuada, técnica, profesionalizada, de reciclaje y actualización (distinta a la formación académica reglada y a la sanitaria)

1 Título de la formación: Programa de Aceleración Dinamiza 2020

Entidad de titulación: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 15/07/2020

Duración en horas: 48 horas

2 Tipo de la formación: Curso

Título de la formación: Curso de Gestión Directiva en Organismos de I+D+i

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: FUNDACION GENERAL CSIC

Fecha de finalización: 15/03/2019

Duración en horas: 170 horas

3 Tipo de la formación: Curso

Título de la formación: GESTIÓN POSITIVA DE CONFLICTOS

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal



Fecha de finalización: 18/10/2018

Duración en horas: 20 horas

4 Tipo de la formación: Curso

Título de la formación: ADOBE PHOTOSHOP AVANZADO 1ª EDICIÓN

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 27/04/2018

Duración en horas: 20 horas

5 Tipo de la formación: Curso

Título de la formación: FRANCES ON LINE

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 10/06/2016

Duración en horas: 40 horas

6 Tipo de la formación: Curso

Título de la formación: COACHING: UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE EQUIPOS

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 12/05/2016

Duración en horas: 20 horas

7 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: Introducción al Método GTD (Get Things Done)

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 28/05/2015

Duración en horas: 9 horas

8 Título de la formación: Curso de formación directiva y gerencial

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 17/03/2015

Duración en horas: 60 horas

9 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: GESTIÓN EFICAZ DEL TIEMPO ON LINE

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 06/10/2014

Duración en horas: 30 horas

10 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: Machine Shop Training: Band saw, Lathe, Milling, etc..

Ciudad entidad titulación: NY, NY, Estados Unidos de América

Entidad de titulación: Columbia University, NY

Fecha de finalización: 03/02/2009

Duración en horas: 40 horas

11 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: SolidWorks 2008 Essentials

Ciudad entidad titulación: Murray Hill, NJ, Estados Unidos de América



Entidad de titulación: CIMQUEST CAD/CAM solutions **Tipo de entidad:** Entidad Empresarial
Fecha de finalización: 02/07/2008 **Duración en horas:** 24 horas

12 Título de la formación: Preparación u Gestión de Acciones dentro del 6º Programa Marco de la IDT de la Unión Europea Módulo IV

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 14/04/2005

Duración en horas: 8 horas

13 Título de la formación: Preparación u Gestión de Acciones dentro del 6º Programa Marco de la IDT de la Unión Europea Módulo III

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 13/04/2005

Duración en horas: 8 horas

14 Título de la formación: Preparación u Gestión de Acciones dentro del 6º Programa Marco de la IDT de la Unión Europea Módulo II

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 12/04/2005

Duración en horas: 8 horas

15 Título de la formación: Preparación u Gestión de Acciones dentro del 6º Programa Marco de la IDT de la Unión Europea Módulo I

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 11/04/2005

Duración en horas: 8 horas

16 Título de la formación: Soldadura de aceros inoxidables y aluminios. Procesos de soldeo TIG-MIG-Electrodo Revestido

Entidad de titulación: Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Tipo de entidad: Agencia Estatal

Fecha de finalización: 18/03/2005

Duración en horas: 40 horas

17 Título de la formación: Gestión de Proyectos (1ª Edición), Programa de Formación

Entidad de titulación: Universidad Carlos III de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad

Fecha de finalización: 12/01/2005

Duración en horas: 20 horas

18 Título de la formación: GESTIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (6ª EDICIÓN), PROGRAMA DE FORMACIÓN

Entidad de titulación: Universidad Carlos III de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad

Fecha de finalización: 17/06/2004

Duración en horas: 60 horas

19 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: Política de Seguridad de Redes

Ciudad entidad titulación: Granada, Andalucía, España

Entidad de titulación: Catón Sistemas Alternativos, CIF B-18448258

Fecha de finalización: 03/10/2003

Duración en horas: 12 horas

20 Tipo de la formación: Prácticas

Título de la formación: Nivel Básico de Utilización del Torno, Fresa, Taladradora y otras Herramientas

Ciudad entidad titulación: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Entidad de titulación: Gabinete de Formación del CSIC, Plan de Formación Permanente



Fecha de finalización: 10/05/2002

Duración en horas: 20 horas

Conocimiento de idiomas

Idioma	Comprensión auditiva	Comprensión de lectura	Interacción oral	Expresión oral	Expresión escrita
Francés	A1	A1	A1	A1	A1
Ruso	A1	A1	A1	A1	A1
Inglés	C2	C2	C2	C2	C2

Actividad docente**Formación académica impartida**

- 1 Tipo de docencia:** Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Nanotecnología: luces y sombras del control de la materia a escala atómica
Titulación universitaria: Curso Nanotecnología
Fecha de inicio: 11/07/2016 **Fecha de finalización:** 11/07/2016
Tipo de horas/créditos ECTS: Horas
Nº de horas/créditos ECTS: 7,5
Entidad de realización: Universidad Internacional Menéndez Pelayo **Tipo de entidad:** Universidad
- 2 Titulación universitaria:** Graphene synthesis and properties
Fecha de inicio: 23/04/2014 **Fecha de finalización:** 23/04/2014
Entidad de realización: Setcor
- 3 Tipo de docencia:** Docencia oficial
Nombre de la asignatura/curso: Nanoestructuras de semiconductores III-V
Tipo de programa: Doctorado/a **Tipo de docencia:** Teórica presencial
Tipo de asignatura: Doctorado/a
Titulación universitaria: Doctorado
Curso que se imparte: Nanoestructuras de semiconductores III-V **Frecuencia de la actividad:** 1
Fecha de inicio: 2005 **Fecha de finalización:** 2006
Tipo de horas/créditos ECTS: Horas
Nº de horas/créditos ECTS: 6
Entidad de realización: Universidad Complutense de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Facultad de Ciencias Físicas
Departamento: Departamento de Física de Materiales
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Idioma de la asignatura: Español
- 4 Nombre de la asignatura/curso:** Tecnologías de fabricación en microelectrónica
Titulación universitaria: Programa de post-grado
Fecha de inicio: 01/10/1998 **Fecha de finalización:** 01/12/1998
Entidad de realización: Programa FOCCIMAF'98



Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

- 1 Título del trabajo:** Graphene Synthesis on a surface by Molecular Beam Epitaxy using a carbon-solid source
Codirector/a tesis: Javier Méndez Pérez-Camarero; Jorge Manuel García Martínez
Entidad de realización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Alumno/a: Irene Hernández Rodríguez
Fecha de defensa: 02/04/2017
- 2 Título del trabajo:** Growth of Graphene on h-BN via Molecular Beam Deposition
Tipo de proyecto: Trabajo conducente a obtención de DEA
Entidad de realización: Department: Applied Physics, Universidad de Columbia, NY.
Ciudad entidad realización: New York, Estados Unidos de América
Alumno/a: Antonio Levi
Calificación obtenida: A+
Fecha de defensa: 06/08/2011
- 3 Título del trabajo:** Control de la forma, tamaño y composición de nanoestructuras de semiconductores III-V: anillos y puntos cuánticos
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Codirector/a tesis: Jorge Manuel García Martínez; Jose María Ripalda Cobián
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Alumno/a: Alfonso González Taboada
Calificación obtenida: Sobresaliente cum laude por unanimidad
Fecha de defensa: 29/11/2010
- 4 Título del trabajo:** Large area growth of few layers graphene via molecular beam deposition
Tipo de proyecto: Trabajo conducente a obtención de DEA
Entidad de realización: Universidad de Columbia, NY **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad realización: New York, Estados Unidos de América
Alumno/a: Mason P Jiang
Fecha de defensa: 06/08/2009
- 5 Título del trabajo:** Nanoestructuras autoensambladas mediante epitaxia de haces moleculares de InAs sobre substratos de GaAs(001): De los puntos cuánticos a los anillos cuánticos
Tipo de proyecto: Tesis Doctoral
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Alumno/a: Daniel Granados Ruiz
Calificación obtenida: Sobresaliente cum Laude por unanimidad
Fecha de defensa: 04/07/2006
- 6 Título del trabajo:** ESPECTROSCOPIA DE CAPACITANCIA VOLTAJE APLICADA AL ESTUDIO DE LOS NIVELES ENERGÉTICOS DE PUNTOS CUÁNTICOS DE InAs SOBRE GaAs (001) Y ANILLOS CUÁNTICOS DE In(Ga)As SOBRE GaAs (001)
Tipo de proyecto: Trabajo conducente a obtención de DEA
Tipo de entidad: Universidad



Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Alumno/a: Daniel Granados Ruiz
Fecha de defensa: 14/07/2004

7 Título del trabajo: Electrical and optical properties of Quantum Dots and Quantum Volcanos
Tipo de proyecto: Trabajo conducente a obtención de DEA
Entidad de realización: Universidad Técnica de Eindhoven **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Simon G.J Mathijssen
Fecha de defensa: 05/06/2004

8 Título del trabajo: Quantum Dot Resonant tunneling Diodes
Tipo de proyecto: Trabajo conducente a obtención de DEA
Entidad de realización: Univesidad de California, Santa Barbara, CA, USA **Tipo de entidad:** Universidad
Alumno/a: Paul Molnar
Fecha de defensa: 12/06/1997

Aportaciones más relevantes de su CV de docencia

- 1 Descripción:** XVIII Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 600€
Fecha de finalización: 12/11/2018
- 2 Descripción:** XVII Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 600€
Fecha de finalización: 13/11/2017
- 3 Descripción:** XVI Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 600€
Fecha de finalización: 12/11/2016
- 4 Descripción:** XV Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 300€
Fecha de finalización: 12/11/2015
- 5 Descripción:** Programa de Enriquecimiento Educativo para Alumnos con Altas Capacidades. Profesor experto 6 h.
Identificar palabras clave: Nanomateriales
Ciudad de realización: Tres Cantos, Comunidad de Madrid, España
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** Organismo
Fecha de finalización: 25/04/2015
- 6 Descripción:** XIV Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 300€
Fecha de finalización: 12/11/2014



- 7 Descripción:** XIII Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 300€
Fecha de finalización: 17/11/2013
- 8 Descripción:** XII Semana de la Ciencia
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 600€
Fecha de finalización: 18/10/2012
- 9 Descripción:** VI Semana de la Ciencia y la Tecnología
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 500€
Fecha de finalización: 18/10/2006
- 10 Descripción:** V Semana de la Ciencia y la Tecnología
Entidad organizadora: Comunidad de Madrid **Tipo de entidad:** 400€
Fecha de finalización: 18/10/2005

Experiencia científica y tecnológica

Actividad científica o tecnológica

Proyectos de I+D+i financiados en convocatorias competitivas de Administraciones o entidades públicas y privadas

- 1 Nombre del proyecto:** MULTIPLIER-Dispositivo fotovoltaico multi-terminal con colección lumínica global para maximizar el rendimiento energético
Entidad de realización: Instituto de Micro y Nanotecnología-CSIC
Ciudad entidad realización: Tres Cantos, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Elisa Antolín Fernández; José María Ripalda Cobián
Nº de investigadores/as: 6
Fecha de inicio-fin: 01/01/2019 - 31/12/2021
Cuantía total: 223.850 €
- 2 Nombre del proyecto:** IGNITE-Integración del crecimiento de Grafeno en la tecnología de semiconductores computados
Entidad de realización: Instituto de Micro y Nanotecnología-CSIC **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Ciudad entidad realización: Tres Cantos, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jorge Manuel García Martínez
Nº de investigadores/as: 3
Fecha de inicio-fin: 01/01/2016 - 31/12/2019
Cuantía total: 121.000 €
- 3 Nombre del proyecto:** Colaboración IMM-CSIC con INL en desarrollo de instrumentación para procesos de recubrimiento especiales en sensores
Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones arqueológicas, etc.).
Grado de contribución: Coordinador del proyecto total, red o consorcio
Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid



Ciudad entidad realización: Tres Cantos, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jorge Manuel García Martínez; Fernando Briones Fernández-Pola

Nº de investigadores/as: 4

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Economía y Hacienda

Tipo de entidad: Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombre del programa: Internacionalización de la I+D

Fecha de inicio-fin: 10/08/2011 - 31/12/2016

Cuantía total: 1.000.000 €

Régimen de dedicación: Tiempo completo

4 Nombre del proyecto: REOMS (Reactividad de Moléculas Orgánicas en Superficies)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Javier Mendez

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación

Tipo de entidad: MAT2011-26534

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 01/01/2012 - 01/01/2015

Cuantía total: 394.999,66 €

5 Nombre del proyecto: Tecnologías clave para nanofotónica y nanoplasmonica basadas en nanoestructuras cuánticas epitaxiales

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Benito Alen Millan

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación

Tipo de entidad: 2009501154

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 01/01/2012 - 31/12/2014

Cuantía total: 187.550 €

6 Nombre del proyecto: Tailoring electronic properties of graphene at the nanoscale

Entidad de realización: Columbia University, NY

Ciudad entidad realización: NY, Estados Unidos de América

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Aron Pinczuk

Entidad/es financiadora/s:

US Office of Naval Research – Multi-University-Research-Initiative (MURI)

Fecha de inicio-fin: 01/10/2009 - 30/11/2012

7 Nombre del proyecto: QOIT (Quantum Optics Information Technologies)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Juergen Eshner; Fernando Briones; Jorge Manuel García Martínez

Entidad/es financiadora/s:



Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación **Tipo de entidad:** CSD2006-00019
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2006 - 31/12/2011

8 Nombre del proyecto: Columbia University Center for Studies of transport in Molecular Electronics

Entidad de realización: Columbia University, NY

Ciudad entidad realización: NY, Estados Unidos de América

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Aron Pinczuk

Entidad/es financiadora/s:

US National Science Foundation – NSEC-Initiative

Fecha de inicio-fin: 01/10/2006 - 30/11/2011

9 Nombre del proyecto: NANOCOMIC (Nanoestructuras de Semiconductores como Componentes para la Información Cuántica)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Enrique Calleja; Luisa González

Entidad/es financiadora/s:

Comunidad de Madrid

Tipo de entidad: S-0505/ESP/000200

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2006 - 31/12/2010

10 Nombre del proyecto: NUMANCIA (Nueva generación de materiales, dispositivos y estrategias fotovoltaicas para un mejor aprovechamiento de la energía solar)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Antonio Luque; Fernando Briones

Entidad/es financiadora/s:

Comunidad de Madrid

Tipo de entidad: S-0505/ENE/000310

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2006 - 31/12/2010

11 Nombre del proyecto: Developing novel low dimensional electric & magnetic field effect devices from graphene & other single atomic layers

Entidad de realización: Columbia University, NY

Ciudad entidad realización: NY, Estados Unidos de América

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Aron Pinczuk

Entidad/es financiadora/s:

US Office of Naval Research

Fecha de inicio-fin: 01/01/2006 - 30/11/2009

12 Nombre del proyecto: NANIC (Nanoestructuras de Semiconductores como Componentes para la Información Cuántica)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luisa González

Entidad/es financiadora/s:



Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación **Tipo de entidad:** 2004-09109-C04-01
Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2005 - 31/12/2008

13 Nombre del proyecto: NANOSELF-II (Nanoestructuras de semiconductores compuestos y su aplicación en dispositivos optoelectrónicos y fotónicos)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Yolanda González

Entidad/es financiadora/s:
PGC del Plan Nacional de I+D+I

Fecha de inicio-fin: 31/12/2005 - 31/12/2008

14 Nombre del proyecto: Extensión de las longitudes de onda de aplicación de las nanoestructuras autoensambladas de In(Ga)As(Sb)/GaAs al rango de 1.3 – 1.5 micras

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jose María Ripalda

Entidad/es financiadora/s:
Comunidad autonoma de Madrid

Fecha de inicio-fin: 01/10/2005 - 01/10/2008

15 Nombre del proyecto: SANDiE (Self-Assembled semiconductor Nanostructures for new Devices in photonics and Electronics)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Marius Grundmann; Fernando Briones; Jorge M. Garcia Martínez

Entidad/es financiadora/s:
EU, 6 programa Marco, NMP4-CT-2004-500101

Fecha de inicio-fin: 01/10/2004 - 01/10/2008

16 Nombre del proyecto: NANOALIN-2 (Nuevos tipos de nanoestructuras basadas en semiconductores III-V con alineamiento de bandas de tipo II)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Benito Alen

Entidad/es financiadora/s:
Comunidad de Madrid

Tipo de entidad: 00560M089

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2005 - 31/12/2006

17 Nombre del proyecto: NANOSELF (Nanoestructuras de semiconductores compuestos y su aplicación en dispositivos optoelectrónicos y fotónicos)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid



Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luisa González

Entidad/es financiadora/s:

PGC del Plan Nacional de I+D+I, TIC2002-04096 **Tipo de entidad:** Agencia Estatal

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 31/12/2002 - 31/12/2005

18 Nombre del proyecto: NANOMAT (Acción especial de ayuda complementaria al proyecto Europeo "Self-Assembled Nanostructured Materials for Electronic and Optoelectronic Applications)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jorge M. Garcia Martínez

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Ciencia y Tecnología, MAT2002-10465-E

Fecha de inicio-fin: 01/10/2001 - 01/10/2004

Cuantía total: 68.500 €

19 Nombre del proyecto: NANOMAT (Self-Assembled Nanostructured Materials for Electronic and Optoelectronic Applications)

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Victor V. Moshchalkov; Jorge M. Garcia Martínez

Entidad/es financiadora/s:

Unión Europea, V programa Marco (Growth), **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
G5RD-CT-2001-00545

Fecha de inicio-fin: 01/10/2001 - 01/10/2004

Cuantía total: 2.467.261 €

20 Nombre del proyecto: HETEROESTRUCTURAS HÍBRIDAS CON APLICACIONES EN MAGNETOELECTRÓNICA

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Alfonso Cebollada

Entidad/es financiadora/s:

Ministerio de Ciencia y Tecnología, **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
mat2000-1290-c03-02

Ciudad entidad financiadora: Madrid, Comunidad de Madrid, España

Fecha de inicio-fin: 01/01/2001 - 31/12/2003

21 Nombre del proyecto: LÁSERES SEMICONDUCTORES DE ANILLOS CUÁNTICOS AUTO-ENDSAMBLADOS PARA APLICACIONES EN TELECOMUNICACIONES

Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid

Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jorge M. Garcia Martínez

Entidad/es financiadora/s:

Comunidad Autónoma de Madrid, 07T/0062/2000

Fecha de inicio-fin: 01/01/2001 - 31/12/2002

Cuantía total: 18.650,22 €



- 22** **Nombre del proyecto:** TECNOLOGÍA DE INTEGRACIÓN MONOLÍTICA DE DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS EN CIRCUITOS INTEGRADOS VLSI DE GaAs
Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luisa González
Entidad/es financiadora/s:
CICYT, TIC 1999-1035-C02-01
Fecha de inicio-fin: 31/12/1999 - 31/12/2002
- 23** **Nombre del proyecto:** FABRICATION OF ELEMENTARY MOLECULAR ELECTRONIC DEVICES
Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Ricardo García
Entidad/es financiadora/s:
UNIÓN EUROPEA (ESPRIT IV-22955) **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio-fin: 01/01/1997 - 31/12/2000
- 24** **Nombre del proyecto:** RESONANT TUNNELING SELF ASSEMBLED QUANTUM DOT STRUCTURES FOR ULTRA HIGH DENSITY MEMORIES
Entidad de realización: Universidad de California **Tipo de entidad:** Universidad Santa Barbara
Ciudad entidad realización: Santa Barbara, CA, Estados Unidos de América
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Pierre M. Petroff
Entidad/es financiadora/s:
NSF-STC
Fecha de inicio-fin: 01/01/1997 - 31/12/1999
Cuantía total: 300.000 €
- 25** **Nombre del proyecto:** DISEÑO Y FABRICACIÓN DE DIODOS LASER ESPECÍFICOS PARA SENSORES OPTICOS
Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica **Tipo de entidad:** Agencia Estatal de Madrid
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Luisa González
Entidad/es financiadora/s:
CICYT, TIC:96-1020-C02-01 **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio-fin: 01/08/1997 - 31/07/1999
- 26** **Nombre del proyecto:** SELF ASSEMBLED SEMICONDUCTOR QUANTUM DOT ARRAYS AS DETECTORS AND IMAGING DEVICES IN THE 5-10 MICRON RANGE
Entidad de realización: Universidad de California **Tipo de entidad:** Universidad Santa Barbara
Ciudad entidad realización: Santa Barbara, CA, Estados Unidos de América
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Pierre M. Petroff
Entidad/es financiadora/s:
ARO (U.S. Army Research Office)
Fecha de inicio-fin: 01/01/1996 - 31/12/1998



- 27** **Nombre del proyecto:** ESTRUCTURA, DINAMICA Y PROPIEDADES MAGNETICAS DURANTE EL CRECIMIENTO DE UNA MONOCAPA A LAS SUPERREDES
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Entidad/es financiadora/s: DGICYT
Fecha de inicio-fin: 27/06/1994 - 26/06/1997
- 28** **Nombre del proyecto:** HETEROESTRUCTURAS OF SEMICONDUCTING SILICIDES ON SI. APPLICATIONS TO Si-COMPATIBLE OPTOELECTRONICS DEVICES
Entidad de realización: Universidad Autónoma de Madrid **Tipo de entidad:** Universidad Madrid
Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): J. Derrián; Rodolfo Miranda
Entidad/es financiadora/s: Comisión de la Comunidad Europea
Fecha de inicio-fin: 01/01/1989 - 31/12/1992
- 29** **Nombre del proyecto:** Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo (Fe-Sem)
Identificar palabras clave: Física sm -- estructura de materiales; Física Im -- sistemas de bajas dimensiones y mesoscópicos; Física id -- instrumentación y análisis de datos
Identificar palabras clave: Física sm -- estructura de materiales; Física Im -- sistemas de bajas dimensiones y mesoscópicos; Física id -- instrumentación y análisis de datos
Modalidad de proyecto: De investigación fundamental (incluyendo excavaciones arqueológicas, etc.). **Ámbito geográfico:** Nacional
Grado de contribución: Coordinador del proyecto total, red o consorcio
Entidad de realización: Instituto de Micro y Nanotecnología-CSIC **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Ciudad entidad realización: Tres Cantos, Comunidad de Madrid, España
Nombres investigadores principales (IP, Co-IP,...): Jorge Manuel García Martínez
Nº de investigadores/as: 32
Tipo de participación: Coordinador
Nombre del programa: Infraestructuras Científicas y Técnicas y Equipamiento 2013
Cód. según financiadora: CSIC13-4E-1794
Fecha de inicio: 01/01/2015 **Duración:** 5 años
Entidad/es participante/s: Instituto de Microelectrónica de Madrid
Cuantía total: 534.546 € **Cuantía subproyecto:** 534.546 €
Porcentaje en subvención: 75
Resultados relevantes: Dotar al Instituto de Microelectrónica de Madrid de un Microscopio Electrónico de Barrido de Emisión de Campo
Régimen de dedicación: Tiempo completo
Aportación del solicitante: Coordinación del proyecto.



Resultados

Propiedad industrial e intelectual

- 1 Título propiedad industrial registrada:** ELECTRODOS NANOESTRUCTURADOS PARA LA ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA DE CÉLULAS EN CULTIVO, DISPOSITIVOS, SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS
Inventores/autores/obtenedores: Sahba Mobini; José Miguel García Martín; María Ujeé González Sagardoy; Marisol Martín González; Olga Caballero Calero; Jorge M García Martínez
Entidad titular de derechos: Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Nº de solicitud: P202030626
País de inscripción: España
Fecha de registro: 23/06/2020
- 2 Título propiedad industrial registrada:** SINGLE-AND BI-LAYER GRAPHENE GROWN ON SAPPHIRE BY MOLECULAR BEAM EPITAXY
Tipo de propiedad industrial: Patente de invención
Inventores/autores/obtenedores: Jorge M. García Martínez; Ulrich Wurstbauer; Aron Pinczuk
Entidad titular de derechos: Columbia University, NY, CSIC
Nº de solicitud: 61/906767
País de inscripción: Estados Unidos de América
Fecha de registro: 20/11/2013
Patente española: Si
Patente internacional no UE: Si
C. Autón./Reg. de explotación: España / Estados Unidos de América
- 3 Título propiedad industrial registrada:** System and methods using a glassy carbon heater
Inventores/autores/obtenedores: Jorge M. García Martínez; Aron Pinczuk
Entidad titular de derechos: Columbia University, NY, CSIC
Nº de solicitud: WO 2012/050964 A1
País de inscripción: Estados Unidos de América
Fecha de registro: 19/04/2012
Fecha de concesión: 13/03/2013
C. Autón./Reg. de explotación: España / Estados Unidos de América
- 4 Título propiedad industrial registrada:** Method of growing graphene nanocrystalline layers
Tipo de propiedad industrial: Patente de invención
Inventores/autores/obtenedores: Jorge M. García Martínez; Ulrich Wurstbauer; Aron Pinczuk
Entidad titular de derechos: Columbia University, NY, CSIC
Nº de solicitud: WO/2013/003083-A1
País de inscripción: Estados Unidos de América
Fecha de registro: 03/01/2013
Patente española: Si
Patente internacional no UE: Si
C. Autón./Reg. de explotación: España / Estados Unidos de América



- 5 Título propiedad industrial registrada:** DEVICES WITH GRAPHENE LAYERS
Inventores/autores/obtenedores: Loren N. Pfeiffer; Jorge Manuel Garcia Martinez
Entidad titular de derechos: ALCATEL-LUCENT USA INC.
Nº de solicitud: PCT/US2008/013796
País de inscripción: Estados Unidos de América
Fecha de registro: 17/12/2008
Fecha de concesión: 07/09/2009

Actividades científicas y tecnológicas

Producción científica

- 1 Índice H:** 43
Fecha de aplicación: 28/01/2021
Fuente de Índice H: WOS
- 2 Índice H:** 47
Fecha de aplicación: 28/01/2021
Fuente de Índice H: GOOGLE SCHOLAR

Publicaciones, documentos científicos y técnicos

- 1** David Fuster; Yolanda González; Luisa González; Javier Méndez; Fernando García; Jose L. Córdoba-Cabanillas; Marisa L. Dotor; Raquel Álvaro; Lorena Torné; Jorge M. García. Optimization of a carbon evaporator cell for MBE growth. Vacuum. 181, pp. 109653-1 - 109653-8. Elsevier, 24/07/2020.
DOI: 10.1016/j.vacuum.2020.109653
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Publicación relevante: Si
- 2** Claudia Backes; Amr M. Abdelkader; Concepcion Alonso; Amandine Andrieux-Ledier; Raul Arenal; Jon Azpeitia; Nilanthy Balakrishnan; Luca Banszerus; Julien Barjon; Ruben Bartali; Sebastiano Bellani; Claire Berger; Reinhard Berger; M. M. Bernal Ortega; Carlo Bernard; Peter H. Beton; Andre Beyer; Alberto Bianco; Peter Boggild; Francesco Bonaccorso; Gabriela Borin Barin; Cristina Botas; Rebeca A. Bueno; Daniel Carriazo; Andres Castellanos-Gomez; Meganne Christian; Artur Ciesielski; Tymoteusz Ciuk; Matthew T. Cole; Jonathan Coleman; Camilla Coletti; Luigi Crema; Huanyao Cun; Daniela Dasler; Domenico De Fazio; Noel Diez; Simon Drieschner; Georg S. Duesberg; Roman Fasel; Xinliang Feng; Alberto Fina; Stiven Forti; Costas Galiotis; Giovanni Garberoglio; Jorge M. Garcia; Jose Antonio Garrido; Marco Gibertini; Armin Goelzhaeuser; Julio Gomez; Thomas Greber; Frank Hauke; Adrian Hemmi; Irene Hernandez-Rodriguez; Andreas Hirsch; Stephen A. Hodge; Yves Huttel; Peter U. Jepsen; Ignacio Jimenez; Ute Kaiser; Tommi Kaplas; HoKwon Kim; Andras Kis; Konstantinos Papagelis; Kostas Kostarelos; Aleksandra Krajewska; Kangho Lee; Changfeng Li; Harri Lipsanen; Andrea Liscio; Martin R. Lohe; Annick Loiseau; Lucia Lombardi; Maria Francisca Lopez; Oliver Martin; Cristina Martin; Lidia Martinez; Jose Angel Martin-Gago; Jose Ignacio Martinez; Nicola Marzari; Alvaro Mayoral; John McManus; Manuela Melucci; Javier Mendez; Cesar Merino; Pablo Merino; Andreas P. Meyer; Elisa Miniussi; Vaidotas Miseikis; Neeraj Mishra; Vittorio Morandi; Carmen Munuera; Roberto Munoz; Hugo Nolan; Luca Ortolani; Anna K. Ott; Irene Palacio; Vincenzo Palermo; John Parthenios; Iwona Pasternak; Amalia Patane; Maurizio Prato; Henri Prevost; Vladimir Prudkovskiy; Nicola Pugno; Teofilo Rojo; Antonio Rossi; Pascal Ruffieux; Paolo Samori; Leonard Schue; Eki Setijadi; Thomas Seyller; Giorgio Speranza; Christoph Stampfer; Ingrid Stenger; Wlodek Strupinski; Yuri Svirko; Simone Taioli; Kenneth B. K. Teo; Matteo Testi; Flavia Tomarchio; Mauro Tortello; Emanuele Treossi; Andrey Turchanin; Ester Vazquez; Elvira Villaro; Patrick R. Whelan; Zhenyuan Xia; Rositza Yakimova; Sheng Yang; G. Reza Yazdi; Chanyoung Yim; Duhee Yoon; Xianghui Zhang; Xiaodong Zhuang; Luigi Colombo; Andrea



C. Ferrari; Mar Garcia-Hernandez. Production and processing of graphene and related materials. 2D MATERIALS. 7 - 2, 04/2020. ISSN 2053-1583

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Publicación relevante: Si

- 3** D. Fuster; P. Anacleto; J. Virtuoso; M. Zutter; D. Brito; M. Alves; L. Aparicio; D. Fuertes Marrón; F. Briones; S. Sadewasser; J.M. García. System for manufacturing complete Cu(In,Ga)Se₂ solar cells in situ under vacuum. Solar Energy. 198, pp. 490 - 498. Elsevier, 01/03/2020.

DOI: 10.1016/j.solener.2020.01.073

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Publicación relevante: Si

- 4** Marco Zutter; Jose Virtuoso; Pedro Anacleto; Liam Yasin; Marina Alves; Miguel Madeira; Oleksandr Bondarchuk; Saibal Mitra; David Fuster Signes; Jorge M. Garcia; Fernando Briones; Rolf Waechter; Oliver Kiowski; Dimitrios Hariskos; Diego Colombara; Sascha Sadewasser. Giant V-oc Boost of Low-Temperature Annealed Cu(In,Ga)Se₂ with Sputtered Zn(O,S) Buffers. PHYSICA STATUS SOLIDI-RAPID RESEARCH LETTERS. 13 - 9, WILEY-VCH VERLAG GMBH, 09/2019. ISSN 1862-6254

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Publicación relevante: Si

- 5** Annette S. Plaut; Ulrich Wurstbauer; Sheng Wang; Antonio L. Levy; Lara Fernandes dos Santos; Lei Wang; Loren N. Pfeiffer; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi; Cory R. Dean; James Hone; Aron Pinczuk; Jorge M. Garcia. Exceptionally large migration length of carbon and topographically-facilitated self-limiting molecular beam epitaxial growth of graphene on hexagonal boron nitride. CARBON. 114, pp. 579 - 584. 04/2017. ISSN 0008-6223

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Publicación relevante: Si

- 6** Jorge M. Garcia; Ulrich Wurstbauer; Antonio Levy; Loren N. Pfeiffer; Aron Pinczuk; Annette S. Plaut; Lei Wang; Cory R. Dean; Roberto Buizza; Arend M. Van Der Zande; James Hone; Kenji Watanabe; Takashi Taniguchi. Graphene growth on h-BN by molecular beam epitaxy. Solid State Communications. 152 - 12, pp. 975 - 978. 2012.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 30

Publicación relevante: Si

- 7** U. Wurstbauer; T. Schiros; C. Jaye; A. S. Plaut; R. He; A. Rigosi; C. Gutierrez; D. Fischer; L. N. Pfeiffer; A. N. Pasupathy; A. Pinczuk; J. M. Garcia. Molecular beam growth of graphene nanocrystals on dielectric substrates. Carbon. 50 - 13, pp. 4822 - 4829. 2012.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 8

Publicación relevante: Si

- 8** J. M. Garcia; R. He; M. P. Jiang; P. Kim; L. N. Pfeiffer; A. Pinczuk. Multi layer graphene grown by precipitation upon cooling of nickel on diamond. Carbon. 49 - 3, pp. 1006 - 1012. 2011.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 12

Publicación relevante: Si

- 9** E. Gallardo; L. J. Martinez; A. K. Nowak; D. Sarkar; H. P. van der Meulen; J. M. Calleja; C. Tejedor; I. Prieto; D. Granados; A. G. Taboada; J. M. Garcia; P. A. Postigo. Optical coupling of two distant InAs/GaAs quantum dots by a photonic-crystal microcavity. Physical Review B. 81 - 19, pp. 4 - 4. 2010.



Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 23

Publicación relevante: Si

- 10** Najm Kleemans; J. H. Blokland; A. G. Taboada; H. C. M. van Genuchten; M. Bozkurt; V. M. Fomin; V. N. Gladilin; D. Granados; J. M. Garcia; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; J. T. Devreese; P. M. Koenraad. Excitonic behavior in self-assembled InAs/GaAs quantum rings in high magnetic fields. *Physical Review B*. 80 - 15, 2009.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 17

Publicación relevante: Si

- 11** Najm Kleemans; I. M. A. Bominaar-Silkens; V. M. Fomin; V. N. Gladilin; D. Granados; A. G. Taboada; J. M. Garcia; P. Offermans; U. Zeitler; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; J. T. Devreese; P. M. Koenraad. Oscillatory persistent currents in self-assembled quantum rings. *Physical Review Letters*. 99, 2007.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 109

Publicación relevante: Si

- 12** D. Granados; J. M. Garcia. In(Ga)As self-assembled quantum ring formation by molecular beam epitaxy. *Applied Physics Letters*. 82 - 15, pp. 2401 - 2403. 2003.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 161

Publicación relevante: Si

- 13** J. M. Garcia; L. Gonzalez; M. U. Gonzalez; J. P. Silveira; Y. Gonzalez; F. Briones. InAs/InP(001) quantum wire formation due to anisotropic stress relaxation: in situ stress measurements. *Journal of Crystal Growth*. 227, pp. 975 - 979. 2001.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 64

Publicación relevante: Si

- 14** L. Gonzalez; J. M. Garcia; R. Garcia; F. Briones; J. Martinez-Pastor; C. Ballesteros. Influence of buffer-layer surface morphology on the self-organized growth of InAs on InP(001) nanostructures. *Applied Physics Letters*. 76 - 9, pp. 1104 - 1106. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 119

Publicación relevante: Si

- 15** R. J. Warburton; C. Schaflein; D. Haft; F. Bickel; A. Lorke; K. Karrai; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Optical emission from a charge-tunable quantum ring. *Nature*. 405 - 6789, pp. 926 - 929. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 648

Publicación relevante: Si

- 16** A. Lorke; R. J. Luyken; A. O. Govorov; J. P. Kotthaus; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Spectroscopy of nanoscopic semiconductor rings. *Physical Review Letters*. 84 - 10, pp. 2223 - 2226. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico
Fuente de citas: WOS

Tipo de soporte: Revista
Citas: 607



Publicación relevante: Si

- 17** J. M. Garcia; J. P. Silveira; F. Briones. Strain relaxation and segregation effects during self-assembled InAs quantum dots formation on GaAs(001). Applied Physics Letters. 77 - 3, pp. 409 - 411. 2000.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 86

Publicación relevante: Si

- 18** J. M. Garcia; T. Mankad; P. O. Holtz; P. J. Wellman; P. M. Petroff. Electronic states tuning of InAs self-assembled quantum dots. Applied Physics Letters. 72 - 24, pp. 3172 - 3174. 1998.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 127

Publicación relevante: Si

- 19** J. M. Garcia; G. MedeirosRibeiro; K. Schmidt; T. Ngo; J. L. Feng; A. Lorke; J. Kotthaus; P. M. Petroff. Intermixing and shape changes during the formation of InAs self-assembled quantum dots. Applied Physics Letters. 71 - 14, pp. 2014 - 2016. 1997.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Fuente de citas: WOS

Citas: 453

Publicación relevante: Si

- 20** Rihab Ben Ayed; Mejda Ajili; Jorge M. Garcia; Ahmed Labidi; Najoua Kamoun Turki. Physical properties investigation and gas sensing mechanism of Al: Fe₂O₃ thin films deposited by spray pyrolysis. SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES. 129, pp. 91 - 104. ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD, 05/2019. ISSN 0749-6036

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 21** R. Naouari; W. Ouerghi; F. Bernardot; C. Testelin; M.A. Maaref; J. Martinez-Pastor; D. Granados; J.M. Garcia. Circularly Polarized Emission from Ensembles of InGaAs/GaAs Quantum Rings. Silicon. 9 - 5, pp. 689 - 693. Springer Science+Business Media Dordrecht, 01/09/2017.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 22** M.J. Milla; I. Hernández-Rodríguez; J. Mendez; J.M. Garcia; J.M. Ulloa; A. Guzman. Scanning tunneling spectroscopic monitoring of surface states role on water passivation of InGaAs uncapped quantum dots. RSC Advances. 7, pp. 33137 - 33142. The Royal Society of Chemistry, 29/06/2017.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Autor de correspondencia: No

- 23** K. Abderrafi; R. -Ribeiro Andrade; N. Nicoara; M.F. Cerqueira; M. Gonzalez Debs; H. Limborço; P.M.P. Salomé; J.C. Gonzalez; F. Briones; J.M. Garcia; S. Sadewasser. Epitaxial CuInSe₂ thin films grown by molecular beam epitaxy and migration enhanced epitaxy. Journal Of Crystal Growth. 00 - 00, pp. 00 - 00. Elsevier, 31/05/2017.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Autor de correspondencia: No

- 24** Irene Hernández-Rodríguez; Jorge M. Garcia; José A. Martín-Gago; Pedro L. de Andrés; Javier Méndez. Graphene growth on Pt(111) and Au(111) using a MBE carbon solid-source. Diamond and Related Materials. Elsevier, 05/03/2015. Disponible en Internet en: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.diamond.2015.03.004>>.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

Resultados relevantes: -We grow graphene on Pt and Au by MBE at lower temperature than others methods. -Epitaxial graphene form extended moirés on platinum and dendritic islands on gold. -These morphologies depend on carbon atomic diffusion and growing temperature.

- 25** Hua Yu Feng; Feng Luo; Renata Kekesi; Daniel Granados; David Meneses-Rodríguez; Jorge M. García; Antonio García-Martín; Gaspar Armelles; Alfonso Cebollada. Magnetoplasmonic Nanorings as Novel Architectures with Tunable Magneto-optical Activity in Wide Wavelength Ranges. *Advanced Optical Materials*. 7 - 2, pp. 612 - 617. Wiley, 07/2014. Disponible en Internet en: <<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adom.201400125>>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 26** Sheng Wang; Lara Fernades dos Santos; Ulrich Wurstbauer; Sheng Wang; Loren N. Pfeiffer; James Hone; Jorge M. García; Aron Pinczuk. Single- and bi-layer graphene grown on sapphire by molecular beam epitaxy. *Solid State Communications*. 189, pp. 15 - 20. Elsevier, 2014. Disponible en Internet en: <<http://dx.doi.org/10.1016/j.ssc.2014.03.008>>.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 27** A. S. Plaut; U. Wurstbauer; A. Pinczuk; J. M. Garcia; L. N. Pfeiffer. Counting molecular-beam grown graphene layers. *Applied Physics Letters*. 102 - 241905, pp. 241905-1 - 241905-4. AIP, 2013.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 28** A. M. Beltran; E. A. Marquis; A. G. Taboada; J. M. Ripalda; J. M. Garcia; S. I. Molina. Three dimensional atom probe imaging of GaAsSb quantum rings. *Ultramicroscopy*. 111 - 8, pp. 1073 - 6. 2011.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 29** E. Gallardo; L. J. Martinez; A. K. Nowak; H. P. van der Meulen; J. M. Calleja; C. Tejedor; I. Prieto; D. Granados; A. G. Taboada; J. M. Garcia; P. A. Postigo. Emission polarization control in semiconductor quantum dots coupled to a photonic crystal microcavity. *Optics Express*. 18 - 12, pp. 13301 - 13308. 2010.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 30** J. M. Garcia; R. He; M. P. Jiang; J. Yan; A. Pinczuk; Y. M. Zuev; K. S. Kim; P. Kim; K. Baldwin; K. W. West; L. N. Pfeiffer. Multilayer graphene films grown by molecular beam deposition. *Solid State Communications*. 150 - 17-18, pp. 809 - 811. 2010.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 31** E. Gallardo; L. J. Martinez; A. K. Nowak; D. Sarkar; D. Sanvitto; H. P. van der Meulen; J. M. Calleja; I. Prieto; D. Granados; A. G. Taboada; J. M. Garcia; P. A. Postigo. Single-photon emission by semiconductor quantum rings in a photonic crystal. *Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics*. 27 - 6, pp. A21 - A24. 2010.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 32** A. G. Taboada; A. M. Sanchez; A. M. Beltran; M. Bozkurt; D. Alonso-Alvarez; B. Alen; A. Rivera; J. M. Ripalda; J. M. Llorens; J. Martin-Sanchez; Y. Gonzalez; J. M. Ulloa; J. M. Garcia; S. I. Molina; P. M. Koenraad. Structural and optical changes induced by incorporation of antimony into InAs/GaAs(001) quantum dots. *Physical Review B*. 82 - 23, 2010.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 33** A. G. Taboada; A. M. Sanchez; A. M. Beltran; M. Bozkurt; D. Alonso-Alvarez; B. Alen; A. Rivera; J. M. Ripalda; J. M. Llorens; J. Martin-Sanchez; Y. Gonzalez; J. M. Ulloa; J. M. Garcia; S. I. Molina; P. M. Koenraad. Structural and optical changes induced by incorporation of antimony into InAs/GaAs(001) quantum dots (vol 82, 235316, 2010). *Physical Review B*. 82 - 23, 2010.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 34** D. Alonso-Alvarez; A. G. Taboada; J. M. Ripalda; B. Alen; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; J. M. Garcia; F. Briones; A. Marti; A. Luque; A. M. Sanchez; S. I. Molina. Carrier recombination effects in strain compensated quantum dot stacks embedded in solar cells. *Applied Physics Letters*. 93 - 12, 2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 35** J. Bosch; B. Alen; J. Martinez-Pastor; D. Granados; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Competition between carrier recombination and tunneling in quantum dots and rings under the action of electric fields. Superlattices and Microstructures. 43 - 5-6, pp. 582 - 587. 2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 36** D. Sarkar; L. J. Martinez; I. Prieto-Gonzalez; H. P. van der Meulen; J. M. Calleja; D. Granados; A. G. Taboada; J. M. Garcia; A. R. Alija; P. A. Postigo. Optical emission of InAs/GaAs quantum rings coupled to a two-dimensional photonic crystal microcavity. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures. 40 - 6, pp. 2156 - 2159. 2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 37** W. Ouerghui; J. Martinez-Pastor; J. Gomis; M. Maaref; D. Granados; J. M. Garcia. Temperature dependent optical properties of stacked InGaAs/GaAs quantum rings. Materials Science & Engineering C-Biomimetic and Supramolecular Systems. 28 - 5-6, pp. 887 - 890. 2008.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 38** F. Suarez; D. Fuster; L. Gonzalez; Y. Gonzalez; J. M. Garcia; M. L. Dotor. (InP)₅/(Ga_{0.47}In_{0.53}As)₄ short-period superlattices waveguides for InAs quantum wires lasers. Journal of Crystal Growth. 306 - 1, pp. 16 - 21. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 39** A. G. Taboada; F. Suarez; D. Granados; T. J. Badcock; D. J. Mowbray; K. M. Groom; B. Alen; J. M. Garcia; M. L. Dotor. Electro-optical characterization of self-assembled InAs/GaAs quantum rings embedded in P-i-N and schottky diodes. Physics of Semiconductors, Pts A and B. 893, pp. 909 - 910. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 40** J. Maes; M. Hayne; Y. Sidor; B. Partoens; F. M. Peeters; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; D. Fuster; J. M. Garcia; V. V. Moshchalkov. Electron wave-function spillover in self-assembled InAs/InP quantum wires (vol 70, art no 155311, 2004). Physical Review B. 76 - 19, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 41** J. M. Ripalda; D. Alonso-Alvarez; B. Alen; A. G. Taboada; J. M. Garcia; Y. Gonzalez; L. Gonzalez. Enhancement of the room temperature luminescence of InAs quantum dots by GaSb capping. Applied Physics Letters. 91 - 1, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 42** D. Fuster; B. Alen; L. Gonzalez; Y. Gonzalez; J. Martinez-Pastor; M. U. Gonzalez; J. M. Garcia. Isolated self-assembled InAs/InP(001) quantum wires obtained by controlling the growth front evolution. Nanotechnology. 18 - 3, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 43** B. D. Gerardot; S. Seidl; P. A. Dalgarno; R. J. Warburton; D. Granados; J. M. Garcia; K. Kowalik; O. Krebs; K. Karrai; A. Badolato; P. M. Petroff. Manipulating exciton fine structure in quantum dots with a lateral electric field. Applied Physics Letters. 90 - 4, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 44** S. Seidl; A. Hoge; M. Kroner; K. Karrai; R. J. Warburton; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Modulation spectroscopy on a single self assembled quantum dot. Physica Status Solidi a-Applications and Materials Science. 204 - 2, pp. 381 - 389. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 45** F. Suarez; D. Fuster; L. Gonzalez; Y. Gonzalez; J. M. Garcia; M. L. Dotor; Ieee. Near room temperature InAs quantum wires lasers on InP at short wavelength infrared. 2007 Spanish Conference on Electron Devices, Proceedings. pp. 311 - 314. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 46** D. Alonso-Alvarez; B. Alen; J. M. Garcia; J. M. Ripalda. Optical investigation of type II GaSb/GaAs self-assembled quantum dots. Applied Physics Letters. 91 - 26, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 47** B. Alen; J. Bosch; D. Granados; J. Martinez-Pastor; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Oscillator strength reduction induced by external electric fields in self-assembled quantum dots and rings. Physical Review B. 75 - 4, 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 48** N. Kleemans; I. M. A. Bomiñaar-Silkens; V. M. Fomin; V. N. Gladilin; D. Granados; J. M. Garcia; P. Offermans; U. Zeitler; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; J. T. Devreese; J. H. Wolter; P. M. Koenraad. Oscillatory persistent currents in nano-volcanoes. Physics of Semiconductors, Pts A and B. 893, pp. 683 - 684. 2007.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 49** P. Offermans; P. M. Koenraad; J. H. Wolter; D. Granados; J. M. Garcia; V. M. Fomin; V. N. Gladilin; J. T. Devreese. Atomic-scale structure and formation of self-assembled In(Ga)As quantum rings. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures. 32 - 1-2, pp. 41 - 45. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 50** W. Ouerghui; J. Martinez-Pastor; J. Gomis; A. Melliti; M. A. Maaref; D. Granados; J. M. Garcia. Effect of carrier transfer on the PL intensity in self-assembled In (Ga) As/GaAs quantum rings. European Physical Journal-Applied Physics. 35 - 3, pp. 159 - 163. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 51** V. Donchev; E. S. Moskalenko; K. F. Karlsson; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Enhancement of the photoluminescence intensity of a single InAs/GaAs quantum dot by separate generation of electrons and holes. Physics of the Solid State. 48 - 10, pp. 1993 - 1999. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 52** F. Pulizzi; D. Walker; A. Patane; L. Eaves; M. Henini; D. Granados; J. M. Garcia; V. V. Rudenkov; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; P. Offermans; P. M. Koenraad; G. Hill. Excited states of ring-shaped (InGa)As quantum dots in a GaAs/(AlGa)As quantum well (vol 72, art no 085309, 2005). Physical Review B. 74 - 23, 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 53** W. Ouerghui; J. Martinez-Pastor; J. Gomis; M. A. Maaref; D. Granados; J. M. Garcia. Lateral carrier tunnelling in stacked In(Ga)As/GaAs quantum rings. European Physical Journal B. 54 - 2, pp. 217 - 223. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 54** D. Walker; F. Pulizzi; A. Patane; L. Eaves; D. Granados; J. M. Garcia; M. Henini; V. V. Rudenkov; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; P. Offermans; P. M. Koenraad; G. Hill. Magnetotunneling spectroscopy of ring-shaped (InGa)As quantum dots: Evidence of excited states with 2p(z) character. Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures. 32 - 1-2, pp. 57 - 60. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 55** F. Suarez; D. Fuster; L. Gonzalez; Y. Gonzalez; J. M. Garcia; M. L. Dotor. Self-assembled InAs quantum wire lasers on (001)InP at 1.6 μ m. Applied Physics Letters. 89 - 9, 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 56** J. Gomis; J. Martinez-Pastor; B. Alen; D. Granados; J. M. Garcia; P. Roussignol. Shape dependent electronic structure and exciton dynamics in small In(Ga)As quantum dots. *European Physical Journal B.* 54 - 4, pp. 471 - 477. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 57** W. Ouerghui; A. Melliti; M. A. Maaref; J. Martinez-Pastor; J. Gomis; D. Granados; J. M. Garcia. Size filtering effect in vertical stacks of In(Ga)As/GaAs self-assembled quantum rings. *Materials Science & Engineering C-Biomimetic and Supramolecular Systems.* 26 - 2-3, pp. 297 - 299. 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 58** A. Mazuelas; L. Gonzalez; J. M. Garcia; Y. Gonzalez; T. Schuelli; C. Priester; H. T. Metzger. Strain determination in MBE-grown InAs quantum wires on InP. *Physical Review B.* 73 - 4, 2006.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 59** S. Seidl; M. Kroner; P. A. Dalgarno; A. Hogeleg; J. M. Smith; M. Ediger; B. D. Gerardot; J. M. Garcia; P. M. Petroff; K. Karrai; R. J. Warburton. Absorption and photoluminescence spectroscopy on a single self-assembled charge-tunable quantum dot. *Physical Review B.* 72 - 19, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 60** P. Offermans; P. M. Koenraad; J. H. Wolter; D. Granados; J. M. Garcia; V. M. Fomin; V. N. Gladilin; J. T. Devreese. Atomic-scale structure of self-assembled In(Ga)As quantum rings in GaAs. *Applied Physics Letters.* 87, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 61** T. Ben; A. M. Sanchez; S. I. Molina; D. Granados; J. M. Garcia; S. Kret. Chemical composition and strain distribution of InAs/GaAs(001) stacked quantum rings. *Microscopy of Semiconducting Materials.* 107, pp. 271 - 274. 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 62** B. Alen; J. Martinez-Pastor; D. Granados; J. M. Garcia. Continuum and discrete excitation spectrum of single quantum rings. *Physical Review B.* 72 - 15, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 63** D. Granados; J. M. Garcia. Determination of the energy levels on InAs quantum dots with respect to the GaAs conduction band. *Nanotechnology.* 16 - 5, pp. S282 - S284. 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 64** F. Pulizzi; D. Walker; A. Patane; L. Eaves; M. Henini; D. Granados; J. M. Garcia; V. V. Rudenkov; P. C. M. Christianen; J. C. Maan; P. Offermans; P. M. Koenraad; G. Hill. Excited states of ring-shaped (InGa)As quantum dots in a GaAs/(AlGa)As quantum well. *Physical Review B.* 72 - 8, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 65** F. Suarez; W. Wang; D. Fuster; L. Gonzalez; Y. Gonzalez; D. Golmayo; J. M. Garcia; M. L. Dotor; I. Lee. Luminescence and photocurrent spectroscopy of self-assembled InAs quantum wires on InP(001). 2005 International Conference on Indium Phosphide and Related Materials. pp. 530 - 532. 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 66** V. M. Fomin; V. N. Gladilin; J. T. Devreese; P. Offermans; P. M. Koenraad; J. H. Wolter; J. M. Garcia; D. Granados. Modeling of the magnetization behavior of realistic self-organized InAs/GaAs quantum craters as observed with cross-sectional STM. *Physics of Semiconductors, Pts A and B.* 772, pp. 803 - 804. 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 67** J. Martin-Sanchez; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; M. Tello; R. Garcia; D. Granados; J. M. Garcia; F. Briones. Ordered InAs quantum dots on pre-patterned GaAs(001) by local oxidation nanolithography. *Journal of Crystal Growth*. 284 - 3-4, pp. 313 - 318. 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 68** J. M. Ripalda; D. Granados; Y. Gonzalez; A. M. Sanchez; S. I. Molina; J. M. Garcia. Room temperature emission at 1.6 μm from InGaAs quantum dots capped with GaAsSb. *Applied Physics Letters*. 87 - 20, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 69** D. Granados; J. M. Garcia; T. Ben; S. I. Molina. Vertical order in stacked layers of self-assembled In(Ga)As quantum rings on GaAs (001). *Applied Physics Letters*. 86 - 7, 2005.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 70** J. Maes; M. Hayne; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; D. Fuster; J. M. Garcia; V. V. Moshchalkov. Confinement in self-assembled InAs/InP quantum wires studied by magneto-photoluminescence. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 21 - 2-4, pp. 261 - 264. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 71** J. Maes; M. Hayne; Y. Sidor; B. Partoens; F. M. Peeters; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; D. Fuster; J. M. Garcia; V. V. Moshchalkov. Electron wave-function spillover in self-assembled InAs/InP quantum wires. *Physical Review B*. 70 - 15, 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 72** C. Schulhauser; A. Hoge; R. J. Warburton; A. O. Govorov; K. Karrai; J. M. Garcia; B. D. Gerardot; P. M. Petroff. Electronic quantum dot states induced through photon emission. *Physica Status Solidi C - Semiconductor Nanometer Devices Fundamentals - Concepts - Realisations*. pp. 2079 - 2093. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 73** C. Schulhauser; R. J. Warburton; A. Hoge; A. O. Govorov; K. Karrai; J. M. Garcia; B. D. Gerardot; P. M. Petroff. Emission from neutral and charged excitons in a single quantum dot in a magnetic field. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 21 - 2-4, pp. 184 - 188. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 74** B. Urbaszek; R. J. Warburton; K. Karrai; B. D. Gerardot; P. M. Petroff; J. M. Garcia. Fine structure of highly charged quantum dot excitons: turning dark into bright states. *8th Conference on Optics of Excitons in Confined Systems (Oecs-8)*. pp. 421 - 425. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 75** K. Karrai; R. J. Warburton; C. Schulhauser; A. Hoge; B. Urbaszek; E. J. McGhee; A. O. Govorov; J. M. Garcia; B. D. Gerardot; P. M. Petroff. Hybridization of electronic states in quantum dots through photon emission. *Nature*. 427 - 6970, pp. 135 - 138. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 76** J. M. Garcia; D. Granados; J. P. Silveira; F. Briones. In segregation effects during quantum dot and quantum ring formation on GaAs(001). *Microelectronics Journal*. 35 - 1, pp. 7 - 11. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 77** F. Suarez; D. Granados; M. L. Dotor; J. M. Garcia. Laser devices with stacked layers of InGaAs/GaAs quantum rings. *Nanotechnology*. 15 - 4, pp. S126 - S130. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 78** C. Schulhauser; A. Hogeleg; A. O. Govorov; R. J. Warburton; K. Karrai; J. M. Garcia; B. D. Gerardot; P. M. Petroff. Magneto-excitonic states in charge-tunable self-assembled quantum dots. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 25 - 2-3, pp. 233 - 241. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 79** M. U. Gonzalez; L. Gonzalez; J. M. Garcia; Y. Gonzalez; J. P. Silveira; F. Briones. Stress evolution aspects during InAs/InP (001) quantum wires self-assembling. *Microelectronics Journal*. 35 - 1, pp. 13 - 17. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 80** V. Donchev; K. F. Karlsson; E. S. Moska; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Temperature study of the photoluminescence of a single InAs/GaAs quantum dot. 8th Conference on Optics of Excitons in Confined Systems (Oecs-8). pp. 608 - 611. 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 81** B. Urbaszek; E. J. McGhee; M. Kruger; R. J. Warburton; K. Karrai; T. Amand; B. D. Gerardot; P. M. Petroff; J. M. Garcia. Temperature-dependent linewidth of charged excitons in semiconductor quantum dots: Strongly broadened ground state transitions due to acoustic phonon scattering. *Physical Review B*. 69 - 3, 2004.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 82** B. Urbaszek; E. J. McGhee; J. M. Smith; R. J. Warburton; K. Karrai; B. D. Gerardot; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Charged excitons in individual quantum dots: effects of vertical electric fields and optical pump power. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 17 - 1-4, pp. 35 - 36. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 83** R. J. Warburton; B. Urbaszek; E. J. McGhee; C. Schulhauser; A. Hogeleg; K. Karrai; A. O. Govorov; J. M. Garcia; B. D. Gerardot; P. M. Petroff. Charged excitons in self-assembled quantum dots. *Quantum Confined Semiconductor Nanostructures*. 737, pp. 95 - 105. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 84** K. Takehana; F. Pulizzi; A. Patane; M. Henini; P. C. Main; L. Eaves; D. Granados; J. M. Garcia. Controlling the shape of InAs self-assembled quantum dots by thin GaAs capping layers. *Journal of Crystal Growth*. 251 - 1-4, pp. 155 - 160. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 85** D. Granados; J. M. Garcia. Customized nanostructures MBE growth: from quantum dots to quantum rings. *Journal of Crystal Growth*. 251 - 1-4, pp. 213 - 217. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 86** E. S. Moskalkenko; V. Donchev; K. F. Karlsson; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Effect of an additional infrared excitation on the luminescence efficiency of a single InAs/GaAs quantum dot. *Physical Review B*. 68 - 15, 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 87** K. F. Karlsson; E. S. Moskalkenko; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Effective tuning of the charge-state of single In(Ga)As/GaAs quantum dots by below barrier band gap excitation. *Surface Science*. 532, pp. 843 - 847. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 88** B. Urbaszek; R. J. Warburton; K. Karrai; B. D. Gerardot; P. M. Petroff; J. M. Garcia. Fine structure of highly charged excitons in semiconductor quantum dots. *Physical Review Letters*. 90 - 24, 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 89** H. Renevier; M. G. Proietti; S. Grenier; G. Ciatto; L. Gonzalez; J. M. Garcia; J. M. Gerard; J. Garcia. Glancing angle EXAFS of encapsulated self-assembled InAs/InP quantum wires and InAs/GaAs quantum dots. *Materials Science and Engineering B-Solid State Materials for Advanced Technology*. 101 - 1-3, pp. 174 - 180. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 90** S. Grenier; A. Letoublon; M. G. Proietti; H. Renevier; L. Gonzalez; J. M. Garcia; C. Priester; J. Garcia. Grazing incidence diffraction anomalous fine structure of self-assembled semiconductor nanostructures. *Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam Interactions with Materials and Atoms*. 200, pp. 24 - 33. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 91** A. Letoublon; H. Renevier; M. G. Proietti; C. Priester; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Grazing incidence diffraction anomalous fine structure: a tool for investigating strain distribution and interdiffusion in InAs/InP quantum wires. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 17 - 1-4, pp. 541 - 542. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 92** C. Schulhauser; A. Hogeleg; R. J. Warburton; A. O. Govorov; W. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff; K. Karrai. Magnetic properties of charged excitons in self-assembled quantum dots. *Physica Status Solidi B-Basic Research*. 238 - 2, pp. 293 - 296. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 93** K. F. Karlsson; P. O. Holtz; E. S. Moskalenko; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff; I. Lee. Pure luminescence transitions from a small InAs/GaAs quantum dot exhibiting a single electron level. 2003 International Conference Indium Phosphide and Related Materials, Conference Proceedings. pp. 100 - 101. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 94** N. Nicoara; O. Custance; D. Granados; J. M. Garcia; J. M. Gomez-Rodriguez; A. M. Baro; J. Mendez. Scanning tunnelling microscopy and spectroscopy on organic PTCDA films deposited on sulfur passivated GaAs(001). *Journal of Physics-Condensed Matter*. 15 - 38, pp. S2619 - S2629. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 95** A. Lorke; J. M. Garcia; R. Blossey; R. J. Luyken; P. M. Petroff. Self-organized InGaAs quantum rings - Fabrication and spectroscopy. *Advances in Solid State Physics* 43. 43, pp. 125 - 137. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 96** B. Alen; J. Martinez-Pastor; D. Fuster; J. M. Garcia; L. Gonzalez; S. I. Molina; A. Ponce; R. Garcia. Size self-filtering effect in vertical stacks of InAs/InP self-assembled quantum wires. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 17 - 1-4, pp. 174 - 176. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 97** J. Warburton; B. Urbaszek; E. J. McGhee; C. Schulhauser; A. Hogeleg; K. Karrai; A. Govorov; J. A. Barker; B. D. Gerardot; P. M. Petroff; J. M. Garcia. Spectroscopy of self-assembled quantum rings. *Physics of Semiconductors 2002, Proceedings*. 171, pp. 237 - 244. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 98** J. Martinez-Pastor; B. Alen; C. Rudamas; P. Roussignol; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Vertical stacks of small InAs/GaAs self-assembled dots: resonant and non-resonant excitation. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 17 - 1-4, pp. 46 - 49. 2003.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 99** E. S. Moskalenko; K. F. Karlsson; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Acceptor-induced threshold energy for the optical charging of InAs single quantum dots. *Physical Review B*. 66 - 19, 2002.



Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 100** C. Rudamas; J. Martinez-Pastor; A. Garcia-Cristobal; P. Roussignol; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Carrier recombination in InAs/GaAs self-assembled quantum dots under resonant excitation conditions. *Physica Status Solidi a-Applied Research*. 190 - 2, pp. 583 - 587. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 101** J. Martinez-Pastor; J. Bosch; D. Biswas; B. Alen; J. L. Valdes; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Exciton recombination in self-assembled InAs/GaAs small quantum dots under an external electric field. *Physica Status Solidi a-Applied Research*. 190 - 2, pp. 599 - 603. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 102** E. S. Moskalenko; K. F. Karlsson; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Formation of the charged exciton complexes in self-assembled InAs single quantum dots. *Journal of Applied Physics*. 92 - 11, pp. 6787 - 6793. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 103** C. Schulhauser; D. Haft; C. Schaflein; K. Karrai; R. J. Warburton; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Giant permanent dipole moments of excitons in semiconductor nanostructures. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 13 - 2-4, pp. 161 - 164. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 104** R. J. Warburton; C. Schulhauser; D. Haft; C. Schaflein; K. Karrai; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Giant permanent dipole moments of excitons in semiconductor nanostructures. *Physical Review B*. 65 - 11, 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 105** S. Grenier; M. G. Proietti; H. Renevier; L. Gonzalez; J. M. Garcia; J. Garcia. Grazing-incidence diffraction anomalous fine structure of InAs/InP(001) self-assembled quantum wires. *Europhysics Letters*. 57 - 4, pp. 499 - 505. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 106** M. U. Gonzalez; J. M. Garcia; L. Gonzalez; J. P. Silveira; Y. Gonzalez; J. D. Gomez; F. Briones. In situ measurements of As/P exchange during InAs/InP(001) quantum wires growth. *Applied Surface Science*. 188 - 1-2, pp. 188 - 192. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 107** C. Rudamas; J. Martinez-Pastor; A. Garcia-Cristobal; P. Roussignol; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Influence of the InAs coverage on the phonon-assisted recombination in InAs/GaAs quantum dots. *Surface Science*. 507, pp. 624 - 629. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 108** J. P. Silveira; J. M. Garcia; F. Briones. Limited in incorporation during pseudomorphic InAs/GaAs growth and quantum dot formation observed by in situ stress measurements. *Applied Surface Science*. 188 - 1-2, pp. 75 - 79. 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista

- 109** C. Schulhauser; D. Haft; R. J. Warburton; K. Karrai; A. O. Govorov; A. V. Kalameitsev; A. Chaplik; W. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Magneto-optical properties of charged excitons in quantum dots. *Physical Review B*. 66 - 19, 2002.

Tipo de producción: Artículo científico

Tipo de soporte: Revista



- 110** D. Haft; C. Schulhauser; A. O. Govorov; R. J. Warburton; K. Karrai; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Magneto-optical properties of ring-shaped self-assembled InGaAs quantum dots. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 13 - 2-4, pp. 165 - 169. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 111** A. Lorke; R. Blossey; J. M. Garcia; M. Bichler; G. Abstreiter. Morphological transformation of InGa_{1-y}As islands, fabricated by Stranski-Krastanov growth. *Materials Science and Engineering B-Solid State Materials for Advanced Technology*. 88 - 2-3, pp. 225 - 229. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 112** D. Biswas; B. Allen; J. Martinez-Pastor; L. Gonzalez; J. M. Garcia. Optical characterisation of self assembled GaxIn_{1-x}As/InP quantum wires. *Proceedings of the Eleventh International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices, Vol 1 & 2*. 4746, pp. 1267 - 1270. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 113** K. F. Karlsson; E. S. Moskalenko; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Optical charging of self-assembled InAs/GaAs quantum dots. *Physica Scripta*. T101, pp. 140 - 142. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 114** B. Alen; D. Biswas; J. Martinez-Pastor; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Optical properties of self-assembled GaxIn_{1-x}As/InP quantum wires. *Physica Status Solidi a-Applied Research*. 190 - 3, pp. 763 - 768. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 115** N. Nicoara; I. Cerrillo; D. Xueming; J. M. Garcia; B. Garcia; C. Gomez-Navarro; J. Mendez; A. M. Baro. Preparation and passivation of GaAs(001) surfaces for growing organic molecules. *Nanotechnology*. 13 - 3, pp. 352 - 356. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 116** D. Biswas; B. Alen; J. Bosch; J. Martinez-Pastor; J. M. Garcia; L. Gonzalez. Quenching and enhancement of high energy luminescence from self assembled InAs/GaAs quantum dots under low external electric fields. *Proceedings of the Eleventh International Workshop on the Physics of Semiconductor Devices, Vol 1 & 2*. 4746, pp. 173 - 176. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 117** B. Alen; J. Martinez-Pastor; L. Gonzalez; J. M. Garcia; S. I. Molina; A. Ponce; R. Garcia. Size-filtering effects by stacking InAs/InP (001) self-assembled quantum wires into multilayers. *Physical Review B*. 65 - 24, 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 118** K. F. Karlsson; E. S. Moskalenko; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. The influence of carrier diffusion on the formation of charged excitons in InAs/GaAs quantum dots. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 13 - 2-4, pp. 101 - 104. 2002.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 119** M. U. Gonzalez; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; M. Calleja; J. P. Silveira; J. M. Garcia; F. Briones. A growth method to obtain flat and relaxed In_{0.2}Ga_{0.8}As on GaAs (001) developed through in situ monitoring of surface topography and stress evolution. *Journal of Crystal Growth*. 227, pp. 36 - 40. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 120** K. F. Karlsson; E. S. Moskalenko; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Carrier diffusion in the barrier enabling formation of charged excitons in InAs/GaAs quantum dots. *Acta Physica Polonica A*. 100 - 3, pp. 387 - 395. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 121** C. M. Boubeta; J. L. Menendez; J. L. Costa-Kramer; J. M. Garcia; J. V. Anguita; B. Bescos; A. Cebollada; F. Briones; A. V. Chernykh; I. V. Malikov; G. M. Mikhailov. Epitaxial metallic nanostructures on GaAs. *Surface Science*. 482, pp. 910 - 915. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 122** P. P. Paskov; P. O. Holtz; B. Monemar; J. M. Garcia; W. V. Schoenfeld; P. M. Petroff. Excited-state magnetoluminescence of InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Japanese Journal of Applied Physics Part 1-Regular Papers Short Notes & Review Papers*. 40 - 3B, pp. 1998 - 2001. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 123** S. Grenier; M. G. Proietti; H. Renevier; L. Gonzalez; J. M. Garcia; J. M. Gerard; J. Garcia. Glancing-angle diffraction anomalous fine structure of InAs quantum dots and quantum wires. *Journal of Synchrotron Radiation*. 8, pp. 536 - 538. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 124** A. Lorke; R. J. Luyken; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Growth and electronic properties of self-organized quantum rings. *Japanese Journal of Applied Physics Part 1-Regular Papers Short Notes & Review Papers*. 40 - 3B, pp. 1857 - 1859. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 125** E. S. Moskalenko; K. F. Karlsson; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Influence of excitation energy on charged exciton formation in self-assembled InAs single quantum dots. *Physical Review B*. 6408 - 8, 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 126** D. Haft; R. J. Warburton; K. Karrai; S. Huant; G. Medeiros-Ribeiro; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Luminescence quenching in InAs quantum dots. *Applied Physics Letters*. 78 - 19, pp. 2946 - 2948. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 127** R. J. Warburton; C. Schaflein; D. Haft; F. Bickel; A. Lorke; K. Karrai; J. M. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff. Optical emission from single, charge-tunable quantum rings. *Physica E*. 9 - 1, pp. 124 - 130. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 128** B. Alen; J. Martinez-Pastor; A. Garcia-Cristobal; L. Gonzalez; J. M. Garcia. Optical transitions and excitonic recombination in InAs/InP self-assembled quantum wires. *Applied Physics Letters*. 78 - 25, pp. 4025 - 4027. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 129** P. P. Paskov; P. O. Holtz; B. Monemar; J. M. Garcia; W. V. Schoenfeld; P. M. Petroff. Optical up-conversion processes in InAs quantum dots. *Japanese Journal of Applied Physics Part 1-Regular Papers Short Notes & Review Papers*. 40 - 3B, pp. 2080 - 2083. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 130** J. P. Silveira; J. M. Garcia; F. Briones. Surface stress effects during MBE growth of III-V semiconductor nanostructures. *Journal of Crystal Growth*. 227, pp. 995 - 999. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 131** K. F. Karlsson; E. S. Moskalenko; P. O. Holtz; B. Monemar; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Temperature influence on optical charging of self-assembled InAs/GaAs semiconductor quantum dots. *Applied Physics Letters*. 78 - 19, pp. 2952 - 2954. 2001.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 132** P. P. Paskov; P. O. Holtz; S. Wongmanerod; B. Monemar; J. M. Garcia; W. V. Schoenfeld; P. M. Petroff. Auger processes in InAs self-assembled quantum dots. *Physica E*. 6 - 1-4, pp. 440 - 443. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 133** E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Carrier-carrier correlations in an optically excited single semiconductor quantum dot. *Physical Review B*. 61 - 16, pp. 11009 - 11020. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 134** J. A. Prieto; G. Armelles; J. M. Garcia; L. Gonzalez; A. San Paulo; R. Garcia. Critical size for localization of the L-like conduction states in InAs quantum dots grown on GaAs. *Applied Physics Letters*. 76 - 20, pp. 2919 - 2921. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 135** H. Pettersson; R. J. Warburton; A. Lorke; K. Karrai; J. P. Kotthaus; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Excitons in self-assembled quantum ring-like structures. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 6 - 1-4, pp. 510 - 513. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 136** R. J. Warburton; C. Schaflein; H. Pettersson; D. Haft; F. Bickel; C. S. Durr; K. Karrai; J. P. Kotthaus; G. Rebeiros-Ribeiro; J. Garcia; W. Schoenfeld; P. M. Petroff; N. Carlsson; W. Seifert; L. Samuelson. Interband optics of charge-tunable quantum dots. *Optical Properties of Semiconductor Nanostructures*. 81, pp. 347 - 363. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 137** P. P. Paskov; P. O. Holtz; B. Monemar; J. M. Garcia; W. V. Schoenfeld; P. M. Petroff. Magnetoluminescence of highly excited InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Physical Review B*. 62 - 11, pp. 7344 - 7349. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 138** I. Kegel; T. H. Metzger; A. Lorke; J. Peisl; J. Stangl; G. Bauer; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Nanometer-scale resolution of strain and interdiffusion in self-assembled InAs/GaAs quantum dots. *Physical Review Letters*. 85 - 8, pp. 1694 - 1697. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 192
- 139** E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Optical spectroscopy of single self assembled quantum dots. *Semiconductor Quantum Dots*. 571, pp. 135 - 146. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 140** P. P. Paskov; P. O. Holtz; B. Monemar; J. M. Garcia; W. V. Schoenfeld; P. M. Petroff. Photoluminescence up-conversion in InAs/GaAs self-assembled quantum dots. *Applied Physics Letters*. 77 - 6, pp. 812 - 814. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 141** J. A. Prieto; G. Armelles; C. Priester; J. M. Garcia; L. Gonzalez; R. Garcia. Strain-induced optical anisotropy in self-organized quantum structures at the E-1 transition. *Applied Physics Letters*. 76 - 16, pp. 2197 - 2199. 2000.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 142** A. Lorke; R. J. Luyken; M. Fricke; J. P. Kotthaus; G. Medeiros-Ribeiro; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Electronic structure of nanometer-size quantum dots and quantum rings. *Microelectronic Engineering*. 47 - 1-4, pp. 95 - 99. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 143** V. Blum; C. Rath; S. Muller; L. Hammer; K. Heinz; J. M. Garcia; J. E. Ortega; J. E. Prieto; O. S. Hernan; J. M. Gallego; A. L. V. de Parga; R. Miranda. Fe thin-film growth on Au(100): A self-surfactant effect and its limitations. *Physical Review B*. 59 - 24, pp. 15966 - 15974. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 144** I. Kegel; T. H. Metzger; P. Fratzl; J. Peisl; A. Lorke; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Interdependence of strain and shape in self-assembled coherent InAs islands on GaAs. *Europhysics Letters*. 45 - 2, pp. 222 - 227. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 145** K. H. Schmidt; J. Garcia; G. Medeiros-Ribeiro; U. Kunze; P. M. Petroff. Optical properties of charged InAs-quantum dots. *Proceedings of the Fifth International Symposium on Quantum Confinement: Nanostructures*. 98 - 19, pp. 213 - 226. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 146** M. U. Gonzalez; J. A. Sanchez-Gil; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; R. Garcia; A. San Paulo; J. M. Garcia. Surface characterization of III-V heteroepitaxial systems by laser light scattering. *Journal of Crystal Growth*. 202, pp. 137 - 140. 1999.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 147** K. H. Schmidt; U. Kunze; G. Medeiros-Ribeiro; J. M. Garcia; P. Wellmann; P. M. Petroff. Field dependent carrier dynamics and charged excitons in InAs self-assembled quantum dots. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 2 - 1-4, pp. 627 - 631. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 148** P. J. Wellmann; J. M. Garcia; J. L. Feng; P. M. Petroff. Giant magnetoresistance in a low-temperature GaAs/MnAs nanoscale ferromagnet hybrid structure. *Applied Physics Letters*. 73 - 22, pp. 3291 - 3293. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 149** S. Maimon; E. Finkman; G. Bahir; S. E. Schacham; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Intersublevel transitions in InAs/GaAs quantum dots infrared photodetectors. *Applied Physics Letters*. 73 - 14, pp. 2003 - 2005. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 208
- 150** E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; D. Spektor; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Multiexciton spectroscopy of a single self-assembled quantum dot. *Physical Review Letters*. 80 - 22, pp. 4991 - 4994. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
Fuente de citas: WOS **Citas:** 287
- 151** E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; D. Spektor; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Optical spectroscopy of a single self-assembled quantum dot. *Physica E-Low-Dimensional Systems & Nanostructures*. 2 - 1-4, pp. 694 - 700. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 152** I. Kegel; T. H. Metzger; J. Peisl; P. Fratzl; A. Lorke; J. P. Kotthaus; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Strain and shape in self-assembled quantum dots studied by X-ray grazing incidence diffraction. *Applications of Synchrotron Radiation Techniques to Materials Science Iv*. 524, pp. 89 - 94. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 153** P. J. Wellmann; W. V. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Tuning of electronic states in self-assembled InAs quantum dots using an ion implantation technique. *Journal of Electronic Materials*. 27 - 9, pp. 1030 - 1033. 1998.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista



- 154** G. MedeirosRibeiro; J. M. Garcia; P. M. Petroff. Charging dynamics of InAs self-assembled quantum dots. *Physical Review B*. 56 - 7, pp. 3609 - 3612. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 155** P. J. Wellmann; J. M. Garcia; J. L. Feng; P. M. Petroff. Formation and properties of nanosize ferromagnetic MnAs particles in low temperature GaAs by manganese implantation. *Magnetic Ultrathin Films, Multilayers and Surfaces* - 1997. 475, pp. 49 - 54. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 156** P. J. Wellmann; J. M. Garcia; J. L. Feng; P. M. Petroff. Formation of nanoscale ferromagnetic MnAs crystallites in low-temperature grown GaAs. *Applied Physics Letters*. 71 - 17, pp. 2532 - 2534. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 157** K. H. Schmidt; G. MedeirosRibeiro; J. Garcia; P. M. Petroff. Size quantization effects in InAs self-assembled quantum dots. *Applied Physics Letters*. 70 - 13, pp. 1727 - 1729. 1997.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 158** C. J. Pastor; C. Limones; J. J. Hinarejos; J. M. Garcia; R. Miranda; J. GomezGoni; J. E. Ortega; H. D. Abruna. Strain-induced enhanced solubility of Au in epitaxial films of Fe. *Surface Science*. 364 - 1, pp. L505 - L510. 1996.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 159** J. M. Garcia; O. Sanchez; P. Segovia; J. E. Ortega; J. Alvarez; A. L. V. Deparga; R. Miranda. CONFINING SURFACE-STATE ELECTRONS IN LESS-THAN 2 DIMENSIONS - A SPECTROSCOPIC STUDY. *Applied Physics a-Materials Science & Processing*. 61 - 6, pp. 609 - 613. 1995.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 160** O. Sanchez; J. M. Garcia; P. Segovia; J. Alvarez; A. L. V. Deparga; J. E. Ortega; M. Prietsch; R. Miranda. LATERAL CONFINEMENT OF SURFACE-STATES ON STEPPED CU(111). *Physical Review B*. 52 - 11, pp. 7894 - 7897. 1995.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 161** J. L. Martinezalbertos; J. Camarero; J. M. Garcia; C. J. Pastor; J. M. Gallego; C. Limones; J. E. Prieto; A. L. V. Deparga; J. Delafiguera; C. Ocal; R. Miranda. A STRUCTURAL CHARACTERIZATION OF THE BUFFER LAYER FOR GROWTH OF MAGNETICALLY COUPLED CO/CU SUPERLATTICES. *Journal of Magnetism and Magnetic Materials*. 121 - 1-3, pp. 20 - 23. 1993.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 162** J. M. Gallego; J. M. Garcia; J. E. Ortega; A. L. V. Deparga; J. Delafiguera; C. Ocal; R. Miranda. GROWTH OF EPITAXIAL IRON DISILICIDE ON SI(100). *Surface Science*. 270, pp. 1016 - 1021. 1992.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 163** J. M. Gallego; J. M. Garcia; J. Alvarez; R. Miranda. METALLIZATION-INDUCED SPONTANEOUS SILICIDE FORMATION AT ROOM-TEMPERATURE - THE FE/SI CASE. *Physical Review B*. 46 - 20, pp. 13339 - 13344. 1992.
Tipo de producción: Artículo científico **Tipo de soporte:** Revista
- 164** J. Warburton; B. Urbaszek; E. J. McGhee; C. Schulhauser; A. Hoge; K. Karrai; A. Govorov; J. A. Barker; B. D. Gerardot; P. M. Petroff; J. M. Garcia. Spectroscopy of self-assembled quantum rings. 171, pp. 237 - 244. 2003.
Tipo de producción: Capítulo de libro **Tipo de soporte:** Libro
- 165** Jorge Manuel García Martínez; Benito Alen; Juan Pedro Silveira; Daniel Granados. 0D Band Gap Engineering by MBE Quantum Rings: Fabrication and optical properties. *Physics of Quantum Rings*. Springer, Fomin, Vladimir (Ed.), 31/08/2013. ISBN 978-3-642-39196-5



Tipo de producción: Libro o monografía científica
Autor de correspondencia: Si
Publicación relevante: Si

Tipo de soporte: Libro

Trabajos presentados en congresos nacionales o internacionales

- 1 Título del trabajo:** Nanostructures for Energy Photovoltaics Solar Cells
Nombre del congreso: AGYA International Workshop “Advanced Applications of Emergent Materials”
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Rabat, Marruecos
Fecha de celebración: 03/12/2019
Fecha de finalización: 07/12/2019
Entidad organizadora: Arab-German Young Academy of Sciences and Humanities
Ciudad entidad organizadora: Berlin, Alemania
Disponible en Internet en: <http://www.agya.info/fileadmin/user_upload/Upcoming_Events/2019/Advanced_Applications_27_11_2019.pdf>.
- 2 Título del trabajo:** Development of a Sputtering System for in-situ fabrication of Cu(in,Ga)Se₂ thin-film solar cells: STAR
Nombre del congreso: Iberian Vacuum Conference, RIVA-X
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Bilbao, País Vasco, España
Fecha de celebración: 03/10/2017
Fecha de finalización: 05/10/2017
Entidad organizadora: ASEVA **Tipo de entidad:** Asociaciones y Agrupaciones
Jorge M García Martínez; David Fuster; David Fuertes Marrón; Sascha Sadewasser; Fernando Briones Pola.
- 3 Título del trabajo:** Carbon evaporator for Molecular Beam Epitaxy graphene growth
Nombre del congreso: Iberian Vacuum Conference, RIVA-X
Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Póster
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Bilbao, País Vasco, España
Fecha de celebración: 03/10/2017
Fecha de finalización: 05/10/2017
Entidad organizadora: ASEVA **Tipo de entidad:** Asociaciones y Agrupaciones
Jorge M García Martínez; Irene Hernández Rodríguez; Jose Angel Martín Gago; Javier Mendez.
- 4 Título del trabajo:** New Strategy for Graphene Growth: a MBE Carbon-source
Nombre del congreso: Iberian Vacuum Conference, RIVA-X
Ámbito geográfico: Unión Europea
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Bilbao, País Vasco, España
Fecha de celebración: 03/10/2017
Fecha de finalización: 05/10/2017
Entidad organizadora: ASEVA **Tipo de entidad:** Asociaciones y Agrupaciones



Irene Hernández Rodríguez; Jorge M García Martínez; Jose Angel Martín Gago; Javier Mendez.

- 5** **Título del trabajo:** Nanostructures for energy harvesting: solar cells and thermoelectricity
Nombre del congreso: SOLAR ENERGY MATERIALS AND APPLICATIONS
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Hammamet, Túnez
Fecha de celebración: 05/05/2017
Fecha de finalización: 08/05/2017
Entidad organizadora: ANSOLE
- 6** **Título del trabajo:** Epitaxial CuInSe_2 thin films grown by molecular beam epitaxy and migration enhanced epitaxy
Nombre del congreso: European Materials Research Society (EMRS) spring meeting
Tipo evento: Congreso
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Lille, Francia
Fecha de celebración: 02/05/2016
Fecha de finalización: 06/05/2016
Entidad organizadora: EMRS
Kamal Abderrafi; R R-Andrade; N Nicoara; H Limborço; J.C. Gonzalez; P.M.P. Salomé; F. Briones; J.M. Garcia; S. Sadewasser.
- 7** **Título del trabajo:** MBE-grown nanostructures, thermoelectric nanomaterials and nanomechanical systems
Nombre del congreso: 2nd World Congress and Expo on Nanotechnology and Materials Science
Autor de correspondencia: Si
Ciudad de celebración: Dubai, Emiratos Árabes Unidos
Fecha de celebración: 04/04/2016
Fecha de finalización: 06/04/2016
Entidad organizadora: Scientific Future Group
Jorge M. Garcia.
- 8** **Título del trabajo:** MBE growth of Quantum nanostructures for optoelectronics
Nombre del congreso: Workshop on Frontier Photonic and Electronic Materials and Devices -2015 German-Japanese-Spanish Joint Workshop
Tipo evento: Congreso
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Autor de correspondencia: No
Ciudad de celebración: Kyoto, Japón
Fecha de celebración: 11/07/2015
Fecha de finalización: 14/07/2015
Entidad organizadora: The 162nd Committee on Wide Bandgap Semiconductor Photonic and Electronic Devices, Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Ciudad entidad organizadora: Kyoto, Japón
Jorge M. Garcia; Sheng Wang; Annette Plaut; Ulrich Wurstbauer; Aron Pinczuk; Jose M. Ripalda; Daniel Granados; Benito Alen; Yolanda González; Luisa González. Disponible en Internet en: <<http://jsps162.jpn.org/gjs.html>>.
- Ámbito geográfico:** Internacional
Intervención por: Por invitación
Tipo de entidad: Organismo Público de Investigación



- 9** **Título del trabajo:** MBE growth of Quantum nanostructures for optoelectronics
Nombre del congreso: NANOTECH MEET Tunisia 2014 joint international conferences
Tipo evento: Congreso **Ámbito geográfico:** Internacional
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote **Intervención por:** Por invitación
Ciudad de celebración: Hammamet, Túnez
Fecha de celebración: 24/04/2014
Fecha de finalización: 26/04/2014
Entidad organizadora: SETCOR, <http://www.setcor.org>
Jorge M. Garcia; Jose M. Ripalda; Daniel Granados; Benito Alen; Yolanda González; Luisa González; Sheng Wang; Annette Plaut; Ulrich Wurstbauer; Aron Pinczuk.
- 10** **Título del trabajo:** Graphene growth on Pt(111) and Au(111) using a MBE solid carbon source
Nombre del congreso: GrapEsp – A European Conference/Workshop on the Synthesis, Characterization and Applications of Graphene.
Ciudad de celebración: Lanzarote, Canarias, España
Fecha de celebración: 18/02/2014
Fecha de finalización: 21/02/2014
Entidad organizadora: Graphene Flagship EU
Irene Hernández-Rodríguez; J.M. García; M.F. López; J.A. Martín-Gago; P.L. de Andrés; J. Méndez.
- 11** **Título del trabajo:** Graphene growth on h-BN by Van der Waals MBE
Nombre del congreso: PDI Topical Workshop on MBE-Grown Graphene
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral **Intervención por:** Por invitación (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Berlin, Alemania
Fecha de celebración: 19/11/2013
Fecha de finalización: 20/11/2013
Entidad organizadora: Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik Leibniz-Institut im Forschungsverbund Berlin
Jorge M Garcia,; Ulrich Wurstbauer; Sheng Wang; Lara Fernandes dos Santos; Lei Wang; Antonio Levy; K. Watanabe; T. Taniguchi,; Cory R. Dean; Loren N. Pfeiffer; James Hone; Aron Pinczuk.
- 12** **Título del trabajo:** Graphene growth on h-BN by molecular beam epitaxy
Nombre del congreso: 17th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Levi, Finlandia
Fecha de celebración: 10/03/2013
Fecha de finalización: 13/03/2013
Entidad organizadora: Tampere University of technology **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad organizadora: Tampere, Finlandia
Jorge M. Garcia; Ulrich Wurstbauer; Sheng Wang; Lara Fernandes dos Santos; Lei Wang; Antonio Levy; Jungsik Park; Cory R. Dean; Loren N. Pfeiffer; James Hone; Aron Pinczuk. "Graphene growth on h-BN by molecular beam epitaxy".
- 13** **Título del trabajo:** Molecular Beam Epitaxy of graphene nanocrystals
Nombre del congreso: APS March Meeting 2012
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Boston, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 27/02/2012
Fecha de finalización: 02/03/2012

**Entidad organizadora:** APS

Jorge M. García; Ulrich Wurstbauer; Rui He; Albert Rigosi; Theanne Schiros; Annette Plaut; Loren N. Pfeiffer; Philip Kim; Abhay Pasupathy; Aron Pinczuk. "Molecular Beam Epitaxy of graphene nanocrystals".

14 Título del trabajo: Ultra Thin Carbon Molecular Beam Epitaxy on Dielectric Substrates

Nombre del congreso: Imaginenano, Graphene 2011

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Bilbao, País Vasco, España

Fecha de celebración: 11/04/2011

Fecha de finalización: 14/04/2011

Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS

J. M. García; U. Wurstbauer; R. He; A. Rigosi; T. Schiros; A. S. Plaut; P. Kim; L. N. Pfeiffer; A. Pasupathy; A. Pinczuk.

15 Título del trabajo: Graphitic carbon molecular beam epitaxy on dielectric substrates

Nombre del congreso: APS March Meeting 2011

Intervención por: Revisión previa a la aceptación

Ciudad de celebración: Dallas, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 21/03/2011

Fecha de finalización: 21/03/2011

Entidad organizadora: APS

Ulrich Wurstbauer; Rui He; Albert Rigosi; Theanne Schiros; Annette Plaut; Loren N. Pfeiffer; Philip Kim; Abhay Pasupathy; Aron Pinczuk; Jorge M. García. "Graphitic carbon molecular beam epitaxy on dielectric substrates".

16 Título del trabajo: Strain Induced segregation in III-V nanostructures growth.

Nombre del congreso: Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures

Tipo evento: Congreso

Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote

Ciudad de celebración: Bonassola, Italia

Fecha de celebración: 17/09/2006

Fecha de finalización: 22/09/2006

Jorge M García; Daniel Granados; A.G. Taboada; J.P. Silveira; F. Briones.

17 Título del trabajo: Electro-optical characterization of self-assembled InAs/GaAs Quantum Rings embedded in p-i-n and Schottky diodes.

Nombre del congreso: IV Reunión Nacional de Física del Estado Sólido (GEFES)

Ciudad de celebración: Alicante, Comunidad Valenciana, España

Fecha de celebración: 2006

A.G. Taboada; F. Suárez; D. Granados; B. Alén; M.L. Dotor; J.M. García.

18 Título del trabajo: Electro-optical states characterization of self-assembled InAs/GaAs Quantum Rings.

Nombre del congreso: 28th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-28)

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Viena, Austria

Fecha de celebración: 2006

Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)

Alfonso G Taboada; Ferrán Suárez; Daniel Granados; Benito Alén; María L Dotor; Jorge M García; Tom J Badkoc; David J Mowbray; Kriss M Groom.



- 19 Título del trabajo:** Fabrication and characterization of Quantum Rings
Nombre del congreso: Sixth International Workshop on Epitaxial Semiconductors on Patterned Substrates and Novel Index Surfaces (ESPS-NIS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Ciudad de celebración: Nottingham, Reino Unido
Fecha de celebración: 2006
Entidad organizadora: Universidad de Nottingham
Jorge M. García; Daniel Granados.
- 20 Título del trabajo:** InGaAsSb self assembled quantum dots epitaxially grown on GaAs(001)
Nombre del congreso: IV Reunión Nacional de Física del Estado Sólido (GEFES)
Ciudad de celebración: Alicante, Comunidad Valenciana, España
Fecha de celebración: 2006
J. M. Ripalda; D. Granados; Y. González; J. M. García; M. Sánchez; S.I. Molina.
- 21 Título del trabajo:** Morphology, spatial distribution and strain field in InAs/GaAs(001) stacked quantum rings structure.
Nombre del congreso: The 16th International Microscopy Congress
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Sapporo, Japón
Fecha de celebración: 2006
T. T. Ben; A. M. Sánchez; P. Galindo; A.G. Taboada; D. Granados; J. M. García; S I. Molina.
- 22 Título del trabajo:** Observation of modulation of PL intensity in self assembled quantum rings under strong pulsed magnetic fields.
Nombre del congreso: 28th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-28)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Viena, Austria
Fecha de celebración: 2006
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
Jorge M. García; Daniel Granados; Alfonso G. Taboada; Manus Hayne.
- 23 Título del trabajo:** Oscillatory persistent currents in nano-volcanoes.
Nombre del congreso: 28th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-28)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Viena, Austria
Fecha de celebración: 2006
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
N.A.J.M. Kleemans; I.M.A. Bominaar-Silkens; V.M. Fomin; V.N. Gladilin; D. Granados; A.G. Taboada; J.M. García; P. Offermans; U. Zeitler; P.C.M. Christianen; J.C. Maan; J.T. Devreese; J.H. Wolter; P.M. Koenraad.
- 24 Título del trabajo:** Capacitance Spectroscopy of Self-Assembled InGaAs Quantum Rings
Nombre del congreso: 13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Grindelwald, Suiza, Suiza
Fecha de celebración: 2005
Daniel Granados; Jorge M. García.



- 25** **Título del trabajo:** Energy level tuning of Self-Assembled Quantum Dots and Quantum Rings
Nombre del congreso: SPIE - Microtechnologies for the New Millenniu
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Sevilla, España
Fecha de celebración: 2005
Daniel Granados; Jorge M. García.
- 26** **Título del trabajo:** Fabrication and characterization of Quantum Rings
Nombre del congreso: Characterization and Modelling of Self-assembled semiconductors structures
Tipo de participación: Participativo - Póster **Intervención por:** Por invitación
Ciudad de celebración: Eindhoven, Holanda
Fecha de celebración: 2005
Daniel Granados; Jorge M. García.
- 27** **Título del trabajo:** Influence of the spacer layer on InAs/GaAs(001) stacked quantum rings structures
Nombre del congreso: Characterization and Modelling of Self-assembled semiconductors structures
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Eindhoven, Holanda
Fecha de celebración: 2005
T. Ben; S. Molina; Daniel Granados; Jorge M. García.
- 28** **Título del trabajo:** Luminescence and photocurrent spectroscopy of self-assembled InAs Quantum Wires on InP(001)
Nombre del congreso: Indium Phosphide and related Materials Conference (IPRM-17)
Ámbito geográfico: Internacional no UE
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Glasgow, Eastern Scotland, Reino Unido
Fecha de celebración: 2005
F. Suárez; W. Wang; D. Fuster; L. González; Y. González; D. Golmayo; J.M. García; M.L. Dotor.
- 29** **Título del trabajo:** Magnetotunneling spectroscopy of ring-shaped (InGa)As quantum dots: evidence of excited states with 2pz levels
Nombre del congreso: 12th International Conference on Modulated Semiconductors Structures (ICPS-12)
Ciudad de celebración: Albuquerque, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 2005
D. Walker; F. Pulizzi; A. Patanè; L. Eaves; D. Granados; J. M. Garcia; M. Henini; V. V. Rudenkov; P. C. M. Christianen; J.C. Maan; P. Offermans; P. M. Koenraad; G. Hille.
- 30** **Título del trabajo:** Self-assembled InAs Quantum Wires Lasers on InP(001) at 1.66 micron
Nombre del congreso: One Day Quantum Dot
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Nottingham, Reino Unido
Fecha de celebración: 2005
Entidad organizadora: Universidad de Nottingham **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad organizadora: Nottingham, Reino Unido
F. Suárez; W. Wang; D. Fuster; L. González; Y. González; D. Golmayo; J.M. García; M.L. Dotor.
- 31** **Título del trabajo:** Self-assembled InAs Quantum Wires Lasers on InP(001) at 1.66 micron.
Nombre del congreso: 13th European Molecular Beam Epitaxy Workshop
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Grindelwald, Suecia

Fecha de celebración: 2005

F. Suárez; W. Wang; D. Fuster; L. González; Y. González; D. Golmayo; J.M. García; M.L. Dotor.

- 32 Título del trabajo:** The Aharonov-Bohm effect in self-assembled InAs/GaAs quantum rings
Nombre del congreso: 12th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-12)
Ciudad de celebración: Albuquerque, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 2005
V. M. Fomin; V. N. Gladilin; J. T. Devreese; P. Offermans; P. M. Koenraad; J. H. Wolter; D. Granados; J. M. García.
- 33 Título del trabajo:** The Aharonov-Bohm effect in self-assembled InAs/GaAs quantum rings
Nombre del congreso: APS March Meeting
Ciudad de celebración: Los Angeles, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 2005
Entidad organizadora: APS
V.M. Fomin; V.N. Gladilin; J.T. Devreese; P. Offermans; P.M. Koenraad; J.H. Wolter; D. Granados; J.M. García.
- 34 Título del trabajo:** Towards big Quantum dots with InGaAs/GaAsSb claddings layers for longer wavelength emission
Nombre del congreso: One Day Quantum Dot
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Nottingham, Reino Unido
Fecha de celebración: 2005
Entidad organizadora: Universidad de Nottingham
J. M. Ripalda; D. Granados; Y. González; L. González; M.L. Dotor; J. M. García.
- 35 Título del trabajo:** Capacitance Spectroscopy of Self-Assembled InGaAs Quantum Rings
Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference-TNT
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Segovia, España
Fecha de celebración: 2004
Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS
Daniel Granados; Jorge M. García.
- 36 Título del trabajo:** Electronic structure of Self-Assembled InAs/InP quantum wires
Nombre del congreso: Belgium Physical Society Conference
Ciudad de celebración: Brussels, Bélgica
Fecha de celebración: 2004
Entidad organizadora: Belgium Physical Society
Y. Sidor; B. Partoens; F. Peeters; J. Maes; M. Hayne; L. Gonz´laez; D. Fustaer; J.M. García; V.V. Moshchalkov.
- 37 Título del trabajo:** InGaAs Quantum dots with soft confinement potential for longer wavelength emission
Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference-TNT
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Segovia,
Fecha de celebración: 2004
Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS
J. M. Ripalda; D. Granados; J. M. Garcia; Y. Gonzalez; L. Gonzalez.



- 38** **Título del trabajo:** Room-Temperature Operation of self-assembled InAs Quantum Wires Lasers on InP(001)
Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference-TNT
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Segovia, España
Fecha de celebración: 2004
Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS
F. Suárez; W. Wang; D. Fuster; L. González; Y. González; D. Golmayo; J.M. García; M.L. Dotor.
- 39** **Título del trabajo:** Accumulated stress evolution during InAsGaA saccumulated stress during QR formation
Nombre del congreso: XXIX reunión bienal de la Real Sociedad Española de Física, GEFES
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 2003
Entidad organizadora: REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FISICA
D. Granados; J.P. Silveira; J.M. García; F. Briones.
- 40** **Título del trabajo:** Charge confinement in self-assembled InAs/InP Quantum Wires studied by magneto-photoluminescence
Nombre del congreso: 11th Conference on Modulated Semiconductors Structures, MSS-11
Ciudad de celebración: Nara, Japón
Fecha de celebración: 2003
J. Maes; M. Hayne; Y. Gonzalez; L. Gonzalez; D. Fuster; J.M. García; V.V. Moshchalkov.
- 41** **Título del trabajo:** Emission from neutral and charged excitons in a single quantum dot in a magnetic field
Nombre del congreso: 11th Conference on Modulated Semiconductors Structures, MSS-11
Ciudad de celebración: Nara, Japón
Fecha de celebración: 2003
C. Schulhauser; R.J. Warburton; A. H-ogele; A.O. Govorov; K. Karrai; J.M. Garcia; B.D. Gerardot; P.M. Petroff.
- 42** **Título del trabajo:** Laser devices with stacked layers of InAs/GaAs quantum rings,
Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference-TNT
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Salamanca, España
Fecha de celebración: 2003
Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS
Daniel Granados; Ferran Suárez; María Luisa Dotor; Jorge M. García.
- 43** **Título del trabajo:** MBE in situ characterization: Quantum Dot and Ring formation
Nombre del congreso: NANO´2003 3rd. Ibero American Workshop on Nanostructures for Application In Micro and Optoelectronics
Tipo de participación: Participativo - Ponencia invitada/ Keynote
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 2003
J.M. García (INVITADA).
- 44** **Título del trabajo:** Pure Luminescence Transitions from a Small InAs/GaAs Quantum Dot Exhibiting a Single Excitonic Level
Nombre del congreso: 15th International Conference on Indium Phosphide Materials and Related Materials



Ciudad de celebración: Santa Barbara, California, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 2003

K.F. Karlsson; P.O. Holtz; E.S. Moskalenko; B. Monemar; W.V.Schoenfeld; J.M. Garcia; P.M.Petroff.

45 Título del trabajo: The quantum dot as a sensitive probe for impurities in the vicinity of the quantum dot

Nombre del congreso: 11th Conference on Modulated Semiconductors Structures, MSS-11

Ciudad de celebración: Nara, Japón

Fecha de celebración: 2003

K.F. Karlsson; P.O. Holtz; E.S. Moskalenko; B. Monemar; W.V.Schoenfeld; J.M. Garcia; P.M.Petroff.

46 Título del trabajo: In situ stress monitoring during growth of InAs on InP(001)

Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference (TNT 2002)

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, Galicia, España

Fecha de celebración: 2002

Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS

M. U. González; J. M. García; L. González; J. P. Silveira; Y. González; F. Briones.

47 Título del trabajo: Morphological control and optical tuning of InAs on GaAs(100) nanostructures: from quantum dots to quantum rings

Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference (TNT 2002)

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, Galicia, España

Fecha de celebración: 2002

Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS

D. Granados; J.M. García.

48 Título del trabajo: Optical tuning via morphological control of InAs on GaAs(100) nanostructures: from quantum dots to quantum rings

Nombre del congreso: International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-26)

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Edingburgo, Eastern Scotland, Reino Unido

Fecha de celebración: 2002

D. Granados; J.M. García.

49 Título del trabajo: Size control of self-assembled quantum wires for 1.5 micron wavelength engineering

Nombre del congreso: XIIth International Conference on Molecular Beam Epitaxy, MBE-XII

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: San Francisco, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 2002

L. González; Y. González; D. Granados; J. M. García; D. Fuster; J.Martínez-Pastor.

50 Título del trabajo: Size self-filtering effect in vertical stacks of InAs/InP self-assembled quantum wires

Nombre del congreso: International Conference on Semiconductor nano-structures and nano-devices

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Toulouse, Francia

Fecha de celebración: 2002

B. Alén; J. Martínez-Pastor; D. Fuster; L. González; J. M. García; S. I. Molina; A. Ponce; R. García.



- 51 Título del trabajo:** Spectroscopy of self-assembled quantum rings
Nombre del congreso: International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-26)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Edingburgo, Eastern Scotland, Reino Unido
Fecha de celebración: 2002
Richard J. Warburton; Bernhard Urbaszek; Christian Schulhauser; Alexander Högele; Khaled Karrai; Jorge M. García; Pierre M. Petroff.
- 52 Título del trabajo:** Temperature and electric field quenching of the photoluminescence in self-assembled InAs/GaAs quantum dots
Nombre del congreso: Trends in Nanotechnology Conference (TNT 2002)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, Galicia, España
Fecha de celebración: 2002
Entidad organizadora: FUNDACION PHANTOMS
D. Fuster; B. Alén; J. Bosch; C. Boubeta; J. Martínez-Pastor; L. González; J.M. García.
- 53 Título del trabajo:** The role of stress and stress anisotropy in semiconductor nanostructures self-assembling
Nombre del congreso: European Material Research Society, Fall Meeting Symposium (E-MRS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Varsovia, Polonia
Fecha de celebración: 2002
M. U. González; J. P. Silveira; J. M. García; L. González; Y. González; F. Briones.
- 54 Título del trabajo:** The role of stress anisotropy in quantum wire and quantum dot formation
Nombre del congreso: XIIth International Conference on Molecular Beam Epitaxy, MBE-XII
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: San Francisco, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 2002
F. Briones; J. P. Silveira; M. U. González; J. M. García; L. González; Y. González.
- 55 Título del trabajo:** Vertical stacks of small InAs/GaAs self-assembled dots: resonant and non-resonant excitation
Nombre del congreso: International Conference on Semiconductor nano-structures and nano-devices
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Toulouse, Francia
Fecha de celebración: 2002
J. Martínez-Pastor; B. Alén; C. Boubeta; Ph. Roussinol; L. González; J.M. García.
- 56 Título del trabajo:** Carrier Recombination in InAs/GaAs Self-Assembled Quantum Dots under Resonant Excitation Conditions
Nombre del congreso: 7th International Conference on Optics and Excitons in Confined Systems (OECS7)
Ciudad de celebración: Montpellier, Francia
Fecha de celebración: 2001
C. Rudazas; J. Martínez-Pastor; A. García-Cristóbal; Ph. Roussinol; J. M. García; L. González.
- 57 Título del trabajo:** Exciton Recombination in Self-Assembled InAs/GaAs Small Quantum Dots under an External Electric Field
Nombre del congreso: 7th International Conference on Optics and Excitons in Confined Systems (OECS7)
Ciudad de celebración: Montpellier, Francia



Fecha de celebración: 2001

J. Martínez-Pastor; J. Bosch; D. Biswas; B. Alén; J. L. Valdés; J. M. García; L. González.

- 58 Título del trabajo:** Giant permanent dipole moments of excitons in semiconductor nanostructures.
Nombre del congreso: 10th International Conference on Modulated Semiconductors Structures (MSS10)
Ciudad de celebración: Linz, Austria
Fecha de celebración: 2001
D C. Schulhauser; D. Haft; R. J. Warburton; K. Karrai; W. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff.
- 59 Título del trabajo:** In situ monitorization of the relaxation process during growth of InAs/GaAs
Nombre del congreso: European Material Research Society, Spring Meeting Symposium (E-MRS)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Estrasburgo, Francia
Fecha de celebración: 2001
M. U. González; Y. González; L. González; J.P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 60 Título del trabajo:** Influence of the InAs-Coverage on the phonon-assisted recombination in InAs/GaAs Quantum Dots
Nombre del congreso: 20th European Conference on Surface Science (ECOSS-20)
Ciudad de celebración: Krakow, Polonia
Fecha de celebración: 2001
C. Rudamás; J. Martínez-Pastor; PH. Roussinol; J.M. García; L. González.
- 61 Título del trabajo:** La anisotropía en la tensión, responsable de la formación espontánea de hilos cuánticos de InAs/InP (001)
Nombre del congreso: Reunión Nacional de Física del Estado Sólido (GEFES)
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 2001
M. U. González; J. M. García; L. González; J. P. Silveira; Y. González; F. Briones.
- 62 Título del trabajo:** Magnetic properties of excitons in charge-tunable quantum rings.
Nombre del congreso: 10th International Conference on Modulated Semiconductors Structures (MSS10)
Ciudad de celebración: Linz, Austria
Fecha de celebración: 2001
D. Haft; C. Schulhauser; A. O. Govorov; R. J. Warburton; K. Karrai; W. Schoenfeld; J. M. Garcia; P. M. Petroff.
- 63 Título del trabajo:** Self-assembling of InAs/InP quantum wires due to stress anisotropy", M. U. González, J. M. García, L. González, J. P. Silveira
Nombre del congreso: European Material Research Society, Spring Meeting Symposium (E-MRS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Estrasburgo.,
Fecha de celebración: 2001
M. U. González; Y. González; L. González; J.P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 64 Título del trabajo:** limited In incorporation during pseudomorphic InAs/GaAs GROWTH AND QD FORMATION OBSERVED BY IN-SITU STRESS MEASUREMENTS.
Nombre del congreso: European Material Research Society, Spring Meeting Symposium (E-MRS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Estrasburgo, Francia
Fecha de celebración: 2001

J.P. Silveira; J.M. Garcia; F. Briones.

- 65** **Título del trabajo:** Caracterización in-situ de los procesos de relajación y la evolución de la rugosidad superficial durante el crecimiento de $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ sobre GaAs por epitaxia de haces moleculares
Nombre del congreso: II Congreso Español de Microscopía de Fuerzas y Efecto Túnel, Fuerzas y Túnel
Tipo evento: Congreso
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santiago de Compostela, Galicia, España
Fecha de celebración: 2000
M. U. González; Y. González; L. González; J. P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 66** **Título del trabajo:** A growth method to obtain flat and relaxed $\text{In}_{0.2}\text{Ga}_{0.8}\text{As}$ on GaAs (001) developed through in-situ monitoring of surface topography and stress evolution
Nombre del congreso: XI th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, MBE-XI
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Pekín, China
Fecha de celebración: 2000
M. U. González; Y. González; L. González; J. P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 67** **Título del trabajo:** Accumulated stress relaxation due to InAs quantum wire formation on $\text{InP}(001)$
Nombre del congreso: XI th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, MBE-XI
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Pekín, China
Fecha de celebración: 2000
J. M. García; L. González; M. U. González; J. P. Silveira; Y. González; A. Mazuelas; F. Briones.
- 68** **Título del trabajo:** As/P exchange reactions study by in-situ stress measurements on $\text{InP}(001)$.
Nombre del congreso: European Conference on Surface Science 19 (ECOSS-19)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Madrid.,
Fecha de celebración: 2000
J.M. García; L. González; M.U. González; J.P. Silveira; Y. González; F. Briones.
- 69** **Título del trabajo:** Electronic Structure of Nanometer-size Quantum Dots and Quantum Rings
Nombre del congreso: International Conference on Semiconductor Quantum Dots (QD 2000)
Ciudad de celebración: Munich, Alemania
Fecha de celebración: 2000
Axel Lorke; R.J. Luyken; M. Fricke; J.P.Kotthaus; G. Medeiros-Ribeiro; J.M. García; P.M. Petroff.
- 70** **Título del trabajo:** Epitaxial metallic/insulator systems on $\text{GaAs}(001)$ for the fabrication of nanostructures.
Nombre del congreso: European Conference on Surface Science 19 (ECOSS-19)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 2000
C.Martínez Boubeta; J.L.Menéndez; J.L.Costa-Krämer; J.M. García; J.V.Anguita; B.Bescós; A.Cebollada; F.Briones; A.V. Chernykh; I.V.Malikov; G.M.Mikhailov.
- 71** **Título del trabajo:** Growth and electronic properties of self-organized quantum rings
Nombre del congreso: International Symposium on Formation, Physics and Device Applications of Quantum Dots Structures (QDS 2000)
Ciudad de celebración: Sapporo, Japón



Fecha de celebración: 2000

A. Lorke; R.J.Luyken; J.M.Garcia; P.M. Petroff.

- 72 Título del trabajo:** In-situ measurement of relaxation and surface roughening during growth of InAs on GaAs
Nombre del congreso: European Conference on Surface Science 19 (ECOSS-19)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 2000
M.U. González; Y. González; L. González; J.P. Silveira; J.M. García; F. Briones.
- 73 Título del trabajo:** Surface stress effects during MBE growth of III-V semiconductor nanostructures.
Nombre del congreso: XI th International Conference on Molecular Beam Epitaxy, MBE-XI
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Pekín, China,
Fecha de celebración: 2000
J. P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 74 Título del trabajo:** Auger Processes in InAs Self Assembled Quantum Dots
Nombre del congreso: 13th International Conference on the Electronic Properties of Two-Dimensional Systems (13th EP2DS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Ottawa, Canadá
Fecha de celebración: 01/08/1999
Fecha de finalización: 06/08/1999
P.Paskov; P.O.Holtz; S.Wongmanerod; J.M.Garcia; W.Schoenfeld; P.M.Petroff.
- 75 Título del trabajo:** Excitons in Self-Assembled Quantum Ring-Like Structures
Nombre del congreso: 13th International Conference on the Electronic Properties of Two-Dimensional Systems(13th EP2DS)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Ottawa, Canada,
Fecha de celebración: 01/08/1999
Fecha de finalización: 06/08/1999
H.Pettersson; R.J.Warburton; A.Lorke; K.Karrai; J.P.Kotthaus; J.M.Garcia; P.M.Petroff.
- 76 Título del trabajo:** Buffer layer surface morphology influence on the self-organization on InAs on InP(001) nanostructures
Nombre del congreso: European Molecular Beam Epitaxy Conference (Euro-MBE 99)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Les Archs, France.,
Fecha de celebración: 1999
L. González; J.M.García; J.Martínez-Pastor; C. Ballesteros; R. García; F.Briones.
- 77 Título del trabajo:** Excitonic recombination in Self-Organized InAs/InP quantum wires.
Nombre del congreso: XXVII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Valencia, España
Fecha de celebración: 1999
Entidad organizadora: Real Sociedad Española de Física
B.Alen; C.Rudamas; J.Martinez-Pastor; J.M.Garcia; L.Gonzalez.



- 78 Título del trabajo:** Indium segregation effects during InAs/(100)GaAs observed via In-situ stress-thickness measurements.
Nombre del congreso: Conferencia de Dispositivos Electrónicos
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 1999
J.M.García; J.Silveira; F.Briones.
- 79 Título del trabajo:** Indium segregation effects during InAs/(100)GaAs observed via In-situ stress-thickness measurements.
Nombre del congreso: Conferencia de Dispositivos Electrónicos (CDE99)
Ciudad de celebración: Madrid,
Fecha de celebración: 1999
J.M.García; J.Silveira; F.Briones.
- 80 Título del trabajo:** Indium segregation effects observed via In-situ strain measurements during InAs/(100)GaAs QD's growth
Nombre del congreso: European Molecular Beam Epitaxy Conference (Euro-MBE 99)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Les Archs, Francia
Fecha de celebración: 1999
J.M.García; J.Silveira; F.Briones.
- 81 Título del trabajo:** Indium segregation effects observed via In-situ strain measurements during InAs/(100)GaAs QD's growth
Nombre del congreso: Xth European Workshop on Molecular Beam Epitaxy (Euro MBE 99)
Ciudad de celebración: Les Archs, France,
Fecha de celebración: 1999
J.M.García; J.Silveira; F.Briones.
- 82 Título del trabajo:** Interband Optics of Charge-tunable quantum dots.
Nombre del congreso: NATO workshop "Optical properties of semiconductor nanostructures"
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Jaszowiec, Polonia
Fecha de celebración: 1999
R.J.Warburton; C.Schäflein; H.Petterson; D.Haft; Fbickel; C.S.Dür; K.Karrai; J.P.Kotthaus;
G.Medeiros-Ribeiro; J.M.García; W.Schoenfeld; P.M.Petroff.
- 83 Título del trabajo:** Seguimiento en tiempo real del estado de tensión y de la morfología superficial durante el crecimiento de InAs sobre GaAs por epitaxia de haces moleculares
Nombre del congreso: Reunión Nacional de Física del Estado Sólido (GEFES)
Ciudad de celebración: Madrid, España
Fecha de celebración: 1999
M. U. González; Y. González; L. González; J. A. Sánchez-Gil; J. P. Silveira; J. M. García; F. Briones.
- 84 Título del trabajo:** Shake Up Processes in InAs Self Assembled Quantum Dots
Nombre del congreso: XXVIII International School on Physics of Semiconducting Compounds
Ciudad de celebración: Jaszowiec, Polonia
Fecha de celebración: 1999
P.O. Holtz; P. Paskov; S. Wongmanerod; J.M. Garcia; W. Schoenfeld; P.M. Petroff.



- 85 Título del trabajo:** Giant magnetoresistance effect in a low-temperature grown GaAs with imbedded MnAs nanomagnets.
Nombre del congreso: Non Stoichiometric III-V compound semiconductors
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Erlangen, Holanda
Fecha de celebración: 1998
P.J. Wellmann; J.M. García; J.-L Feng; P.M. Petroff.
- 86 Título del trabajo:** Giant magnetoresistance effect in a new Irbid granular ferromagnet semiconductor system – MnAs nanomagnets embedded in GaAs
Nombre del congreso: 24th International Conference on the Physics of Semiconductors
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Jerusalem, Israel
Fecha de celebración: 1998
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
P.J. Wellmann; J.M. García; J.-L Feng; P.M. Petroff.
- 87 Título del trabajo:** Infrared Photoconductivity study of the electronic structure in Self-assembled InAs/GaAs Quantum Dot structures,
Nombre del congreso: 24th International Conference on the Physics of Semiconductors
Ciudad de celebración: Jerusalem, Israel
Fecha de celebración: 1998
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
E. Finkman; S. Maimon; G. Bahir; S.E. Schacham; L.R.C. Fonseca; J. Shumway; J.P. Leburton; J.M. García; P.M. Petroff.
- 88 Título del trabajo:** Multiexciton emission in Quenatum Dots: Spectroscopic evidence for a fast exciton thermalization.
Nombre del congreso: 24th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS-24)
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Jerusalén, Israel
Fecha de celebración: 1998
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; D. Spektor; J.M. García; P.M. Petroff.
- 89 Título del trabajo:** Satellite Spectroscopy Performed on InAs Self Assembled Quantum Dots
Nombre del congreso: 24th International Conference on the Physics of Semiconductors (ICPS)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Jerusalem, Israel,
Fecha de celebración: 1998
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
P. O. Holtz; S. Wongmanerod; J.M. Garcža; W. Schoenfeld; P.M. Petroff.
- 90 Título del trabajo:** Satellite Spectroscopy Performed on InAs Self Assembled Quantum Dots.
Nombre del congreso: 24th International Conference on the Physics of Semiconductors
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Jerusalem, Israel
Fecha de celebración: 1998
Entidad organizadora: International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP)
P. O. Holtz; S. Wongmanerod; W. Schoenfeld; J.M. García; P.M. Petroff..



- 91** **Título del trabajo:** Diffraction limited studies of single self assembled quantum dots
Nombre del congreso: Modulated Semiconductors Structures 8 (MSS-8)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santa Barbara, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 1997
E. Dekel; D. Spektor; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; J.M. García; P.M.Petroff.
- 92** **Título del trabajo:** Formation and properties of nanosize ferromagnetic MnAs particles in low temperature GaAs by Manganese Implantation.
Nombre del congreso: MRS Spring
Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)
Ciudad de celebración: Boston, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 1997
Entidad organizadora: MRS
P.J. Wellman; J. M. García; J.-LFeng; P.M. Petroff. "MRS-proceedings 97".
- 93** **Título del trabajo:** Formation and properties of nanosize ferromagnetic MnAs particles in low temperature GaAs by Manganese Implantation.
Nombre del congreso: MRS 97 Spring
Ciudad de celebración: Boston, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 1997
P.J. Wellman; J. M. García; J.-Lfeng; P.M. Petroff.
- 94** **Título del trabajo:** Multi-Exciton Spectroscopy of a Single Self Assembled Quantum Dot
Nombre del congreso: Modulated Semiconductor Structures 8 (MSS8)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santa Barbara,
Fecha de celebración: 1997
E. Dekel; D. Gershoni; E. Ehrenfreund; D. Spektor; J.M. García; P.M.Petroff.
- 95** **Título del trabajo:** Synthesis and properties of nanoscale ferromagnetic MnAs Crystallites using Low-Temperature grown GaAs.
Nombre del congreso: Modulated Semiconductor Structures 8 (MSS8)
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Santa Barbara, California, Estados Unidos de América
Fecha de celebración: 1997
P.J. Wellman; J. M. García; J.-LFeng; P.M. Petroff.
- 96** **Título del trabajo:** Capacitance and Photoluminescence spectroscopy of electronic states in InAs self assembled quantum dots
Nombre del congreso: Escuela de Verano, NATO Advanced Study Institute
Tipo de participación: Participativo - Póster
Ciudad de celebración: Ankara, Turquía
Fecha de celebración: 1996
Entidad organizadora: NATO
J. M. García; K. Schmidt; G. Medeiros-Ribeiro; P. M. Petroff.
- 97** **Título del trabajo:** First stages of Fe overgrowth on Au(100): Autosurfactance effect
Nombre del congreso: Conference on Surface Crystallography
Tipo de participación: Participativo - Póster



Ciudad de celebración: Kloster Banz, Alemania

Fecha de celebración: 1995

J. M. García; O. Sacher; P. Segovia; J. Alvarez; A. L.Vazquez de Parga; J. E. Ortega; M. Prietsh; R. Miranda.

98 Título del trabajo: Lateral confinement of Surface States on stepped Cu(111)

Nombre del congreso: APS Meeting

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: San Jose, Estados Unidos de América

Fecha de celebración: 1995

Entidad organizadora: America Physical Society

O. Sacher; J. M. García; P. Segovia; J. Alvarez; A. L.Vazquez de Parga; J. E. Ortega; M. Prietsh; R. Miranda.

99 Título del trabajo: Lateral confinement of Surface States on stepped Cu(111)

Nombre del congreso: APS Meeting,

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: San Jose,

Fecha de celebración: 1995

Entidad organizadora: America Physical Society

O. Sacher; J. M. García; P. Segovia; J. Alvarez; A. L.Vazquez de Parga; J. E. Ortega; M. Prietsh; R. Miranda. "proceedings APS".

100 Título del trabajo: Scanning Tunneling Microscope study of epitaxial films of Fe on Au(100).

Nombre del congreso: II international summerschool "Nicolas Cabrera", Advances in Surface Science

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Miraflores de la Sierra, Comunidad de Madrid, España

Fecha de celebración: 1995

J.M.García; C.J.Pastor; J. Gomez-Goñi; J.J.J. Hinarejos; E.Ortega; R.Miranda.

101 Título del trabajo: Hydrogen adsorption on epitaxial γ -FeSi₂/Si(111), γ -FeSi₂/Si(100) and single crystal γ -FeSi₂(100)

Nombre del congreso: 14th General Conference Condensed Matter Division

Tipo de participación: Participativo - Ponencia oral (comunicación oral)

Ciudad de celebración: Madrid, España

Fecha de celebración: 1994

J.M.García; C.J.Pastor; J.E.Ortega; J.J.Hinarejos; J.Chrost; E.G.Michel; G.R.Castro; R.Miranda.

102 Título del trabajo: A structural characterization of the buffer layer for growth of Magnetically-coupled Co/Cu superlattices.

Nombre del congreso: Symposium on Magnetic Ultrathin Films, Multilayers and Surfaces

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Lion, Francia

Fecha de celebración: 1992

J.L. Martínez-Albertos; J. Camarero; J.M. García; C. J. Pastor; J.M. Gallego; C. Limones; J. E. Prieto; A. L. Vázquez de Parga; C. Ocal; R. Miranda.

103 Título del trabajo: Growth of epitaxial iron disilicide on Si(100)

Nombre del congreso: 12th European Conference on Surface Science (ECOSS-12)

Tipo de participación: Participativo - Póster

Ciudad de celebración: Estocolmo, Suecia



Fecha de celebración: 1991

J.M. Gallego; J.M. García; J. E. Ortega; A. L. Vázquez de Parga; J. de la Figuera; C. Ocal; R. Miranda.

Gestión de I+D+i y participación en comités científicos

Comités científicos, técnicos y/o asesores

Título del comité: Jurado concurso FOTCIENCIA 2019

Primaria (Cód. Unesco): 330000 - Ciencias Tecnológicas

Secundaria (Cód. Unesco): 220000 - Física

Terciaria (Cód. Unesco): 240000 - Ciencias de la Vida

Entidad de afiliación: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología **Tipo de entidad:** FECYT

Fecha de inicio-fin: 26/12/2019 - 16/01/2020

Gestión de I+D+i

- 1 Nombre de la actividad:** Director
Tipología de la gestión: Gestión de entidad
Funciones desempeñadas: Direccion del Instituto de Micro y Nanotecnología-CNM, CSIC
Entidad de realización: Instituto de Micro y Nanotecnología-CNM, CSIC **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio: 18/04/2017
- 2 Nombre de la actividad:** Comisión de Postgrado y Doctorado de la Asociación para el Desarrollo del CEI UAM+CSIC
Tipología de la gestión: Gestión de entidad
Funciones desempeñadas: Representante del CSIC
Entidad de realización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio: 09/07/2014
- 3 Nombre de la actividad:** Comisión de Campus de la Asociación para el desarrollo del Campus de Excelencia Internacional UAM+CSIC
Tipología de la gestión: Gestión de entidad
Funciones desempeñadas: Representante de la Comisión
Entidad de realización: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio: 10/06/2014
- 4 Nombre de la actividad:** Director
Tipología de la gestión: Gestión de entidad
Funciones desempeñadas: Direccion del Instituto de Microelectrónica de Madrid, CNM, CSIC
Entidad de realización: Instituto de Microelectrónica de Madrid, CNM, CSIC **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de inicio: 18/04/2013 **Duración:** 4 años

Otros méritos

Estancias en centros de I+D+i públicos o privados

- 1** **Entidad de realización:** Columbia University **Tipo de entidad:** Universidad
Ciudad entidad realización: New York, Estados Unidos de América
Fecha de inicio-fin: 02/05/2009 - 02/05/2012 **Duración:** 3 años
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Growth of Graphene by MBE
- 2** **Entidad de realización:** Bell Labs **Tipo de entidad:** Entidad Empresarial
Facultad, instituto, centro: Materials for Communications
Ciudad entidad realización: Murray Hill, Estados Unidos de América
Fecha de inicio-fin: 01/05/2007 - 01/05/2009 **Duración:** 2 años
Entidad financiadora: Ministerio Español
Nombre del programa: Salvador de Madariaga
Objetivos de la estancia: Sabatico
Tareas contrastables: Growth of Graphene by MBE
- 3** **Entidad de realización:** Universidad Católica de Lovaina **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Departamento de Física
Ciudad entidad realización: Lovaina, Bélgica
Fecha de inicio-fin: 04/07/2006 - 12/07/2006 **Duración:** 7 días
Objetivos de la estancia: Realización de medidas EUROMAGNET
Tareas contrastables: Caracterización de anillos cuánticos con altos (50T) campos magnéticos.
- 4** **Entidad de realización:** ESRF **Tipo de entidad:** Centro de I+D
Ciudad entidad realización: Grenoble, Rhône-Alpes, Francia
Fecha de inicio-fin: 13/03/1999 - 18/03/1999 **Duración:** 5 días
Objetivos de la estancia: Medidas en sincrotrón
Tareas contrastables: Determinación de la anisotropía en el plano de crecimiento en Hilos Cuánticos auto-organizados de InAs en InP
- 5** **Entidad de realización:** Ludwig-Maximilians de Munich **Tipo de entidad:** Universidad
Facultad, instituto, centro: Departamento de Física de la Universidad
Ciudad entidad realización: Munich, Oberbayern, Alemania
Fecha de inicio-fin: 12/01/1998 - 11/02/1998 **Duración:** 1 mes
Objetivos de la estancia: Invitado/a
Tareas contrastables: Caracterización eléctrica y óptica de Puntos Cuánticos de InAs/GaAs(100)
- 6** **Entidad de realización:** Universidad de California Santa Barbara
Facultad, instituto, centro: Materials Department
Ciudad entidad realización: Santa Barbara, Estados Unidos de América
Fecha de inicio-fin: 01/01/1997 - 31/12/1997 **Duración:** 2 años
Objetivos de la estancia: Posdoctoral

- 7 Entidad de realización:** Bessy
Ciudad entidad realización: Berlin, Berlin, Alemania
Fecha de inicio-fin: 06/05/1994 - 15/05/1994 **Duración:** 9 días
Objetivos de la estancia: Medidas en sincrotrón
Tareas contrastables: Caracterización de Siliciuros de Hierro

Premios, menciones y distinciones

- 1 Descripción:** Finalista de la sexta edición del concurso Ciencia y Sugerencia 2010
Entidad concesionaria: Consejo Superior de Investigaciones Científicas **Tipo de entidad:** Agencia Estatal
Fecha de concesión: 03/06/2010
- 2 Descripción:** Premio Especial Fotociencia 2006 a la mejor fotografía general sobre ciencia y tecnología de cerámica y vidrio
Entidad concesionaria: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología **Tipo de entidad:** 500€
Fecha de concesión: 26/01/2007
- 3 Descripción:** Premio al mejor póster en el congreso internacional: "Trends in Nanotechnology, TNT2003", por la presentación del trabajo: "Stacked layers of Self Assembled Quantum Rings for 980nm Lasers"
Entidad concesionaria: FUNDACION PHANTOMS
Ciudad entidad concesionaria: Salamanca, España
Fecha de concesión: 19/09/2003
- 4 Descripción:** Premio al mejor póster en el 12th European Conference on Surface Science (ECOSS-12) por la presentación del trabajo: "A new method for the growth of Epitaxial Iron Silicides on Si(100)
Entidad concesionaria: Stockholm University
Ciudad entidad concesionaria: Estocolmo, Suecia
Fecha de concesión: 12/09/1991

Períodos de actividad investigadora

- 1 Nº de tramos reconocidos:** 4
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación **Tipo de entidad:** Sexenio
Fecha de obtención: 17/06/2021
- 2 Nº de tramos reconocidos:** 1
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación **Tipo de entidad:** SEXENIO TRANSFERENCIA
Fecha de obtención: 14/05/2020



Acreditaciones/reconocimientos obtenidos

- 1 Descripción:** Quinquenio de investigación 1991-1995
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tipo de entidad: ANECA
- 2 Descripción:** Quinquenio de investigación 1995-2000
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tipo de entidad: ANECA
- 3 Descripción:** Quinquenio de investigación 2001-2005
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tipo de entidad: ANECA
- 4 Descripción:** Quinquenio de investigación 2006-2010
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tipo de entidad: ANECA
- 5 Descripción:** Quinquenio de investigación 2011-2015
Entidad acreditante: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Tipo de entidad: ANECA